

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6561625号
(P6561625)

(45) 発行日 令和1年8月21日(2019.8.21)

(24) 登録日 令和1年8月2日(2019.8.2)

(51) Int.Cl.

F I

G03G 5/06 (2006.01)
G03G 5/05 (2006.01)G03G 5/06 3 1 2
G03G 5/06 3 1 3
G03G 5/05 1 0 1
G03G 5/05 1 0 4 B
G03G 5/06 3 7 1

請求項の数 10 (全 58 頁)

(21) 出願番号 特願2015-132914 (P2015-132914)
(22) 出願日 平成27年7月1日(2015.7.1)
(65) 公開番号 特開2017-15944 (P2017-15944A)
(43) 公開日 平成29年1月19日(2017.1.19)
審査請求日 平成30年3月7日(2018.3.7)(73) 特許権者 000005496
富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番3号
(74) 代理人 110001519
特許業務法人太陽国際特許事務所
(72) 発明者 井手 健太
神奈川県海老名市本郷2274番地 富士
ゼロックス株式会社内
(72) 発明者 宮本 昌彦
神奈川県海老名市本郷2274番地 富士
ゼロックス株式会社内
(72) 発明者 河合 剛志
神奈川県海老名市本郷2274番地 富士
ゼロックス株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成装置、及びプロセスカートリッジ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

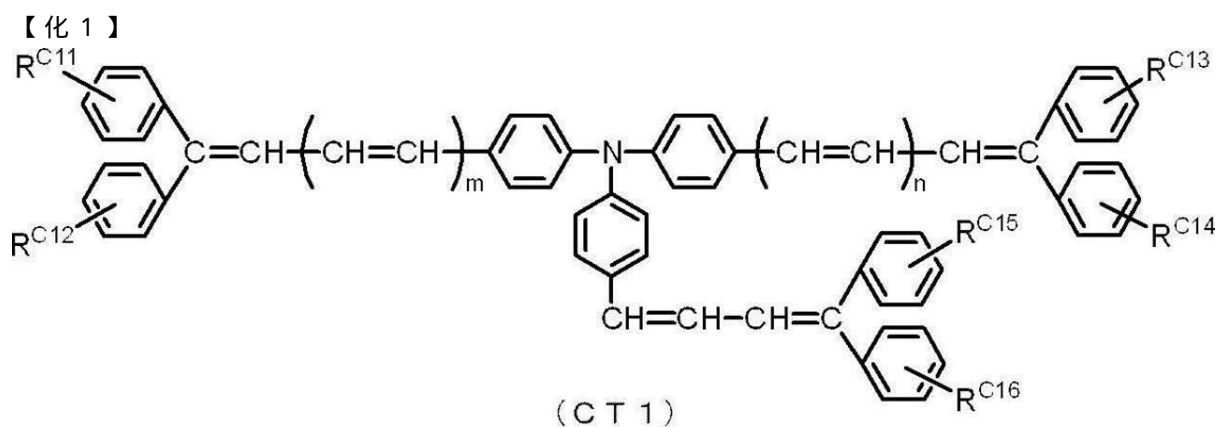
導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料、下記一般式(C T 1)で示される電荷輸送材料、下記一般式(C T 2)で示される電荷輸送材料、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂、並びに、分子量300以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤としての下記一般式(H P)で示される酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種を含む感光層と、を有する電子写真感光体と、

前記電子写真感光体の表面を帯電する帯電手段と、

光源として発光ダイオードを有し、前記発光ダイオードによる露光により、帯電した前記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、

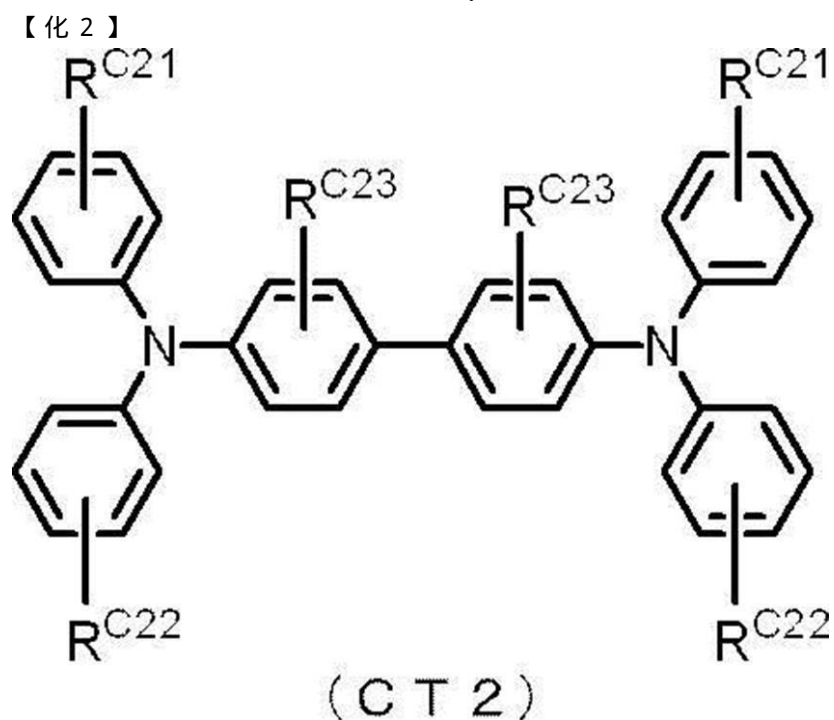
トナーを含む現像剤により、前記電子写真感光体の表面に形成された静電潜像を現像してトナー像を形成する現像手段と、

前記トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、
を備える画像形成装置。



10

(一般式 (CT 1) 中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 30 以下のアリール基を表し、隣接する 2 つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。n 及び m は、各々独立に、0、1 又は 2 を表す。)



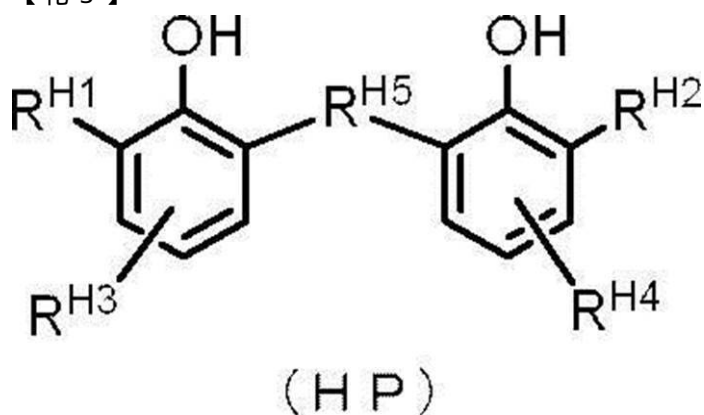
20

30

(一般式 (CT 2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

40

【化 3】



10

(一般式 (HP) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基を表す。 R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す。 R^{H5} は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキレン基を表す。)

【請求項 2】

前記一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子を表し、 m 及び n が 1 を表す請求項 1

20

【請求項 3】

前記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料において、 R^{C21} 、及び R^{C23} が水素原子を表し、 R^{C22} が炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す請求項 1 又は請求項 2 に記載の画像形成装置。

【請求項 4】

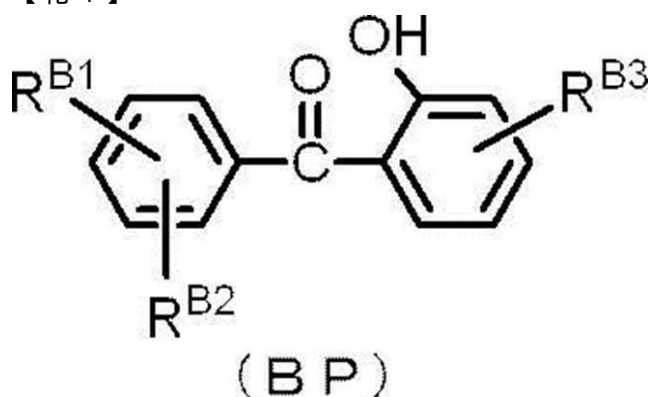
前記一般式 (HP) で示される酸化防止剤において、 R^{H1} 、及び R^{H2} が *tert*-ブチル基を表す請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【請求項 5】

前記ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、下記一般式 (BP) で示される紫外線吸収剤である請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

30

【化 4】



40

(一般式 (BP) 中、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。ただし、 R^{B3} は水酸基を表してもよい。)

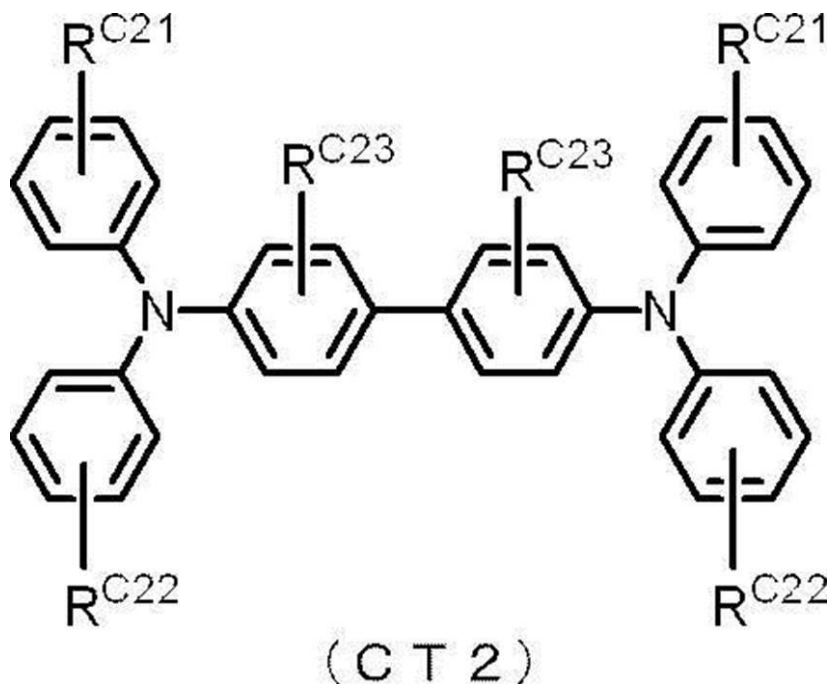
【請求項 6】

前記一般式 (BP) で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤において、 R^{B1} 、及び

50

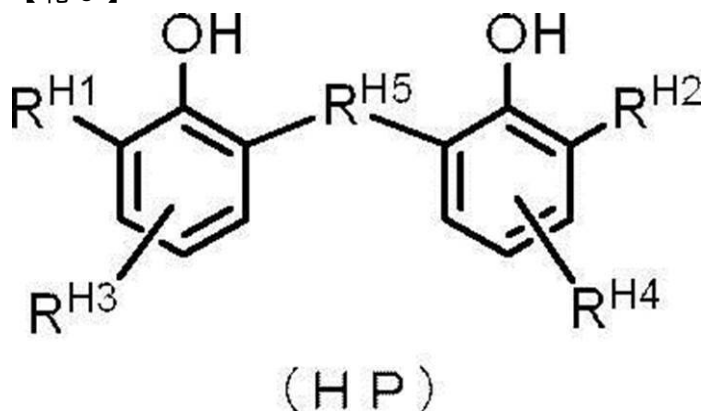
(一般式(CT1)中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上20以下のアルキル基、炭素数1以上20以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上30以下のアリール基を表し、隣接する2つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。 n 及び m は、各々独立に、0、1又は2を表す。)

【化7】



(一般式(CT2)中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上10以下のアルキル基、炭素数1以上10以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上10以下のアリール基を表す。)

【化8】



(一般式(HP)中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数4以上8以下の分岐状のアルキル基を表す。 R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数1以上10以下のアルキル基を表す。 R^{H5} は、炭素数1以上10以下のアルキレン基を表す。)

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、画像形成装置、及びプロセスカートリッジに関する。

【背景技術】

【0002】

従来、電子写真方式の画像形成装置としては、電子写真感光体（以下、「感光体」という場合がある。）を用いて帯電、静電潜像形成、現像、転写、クリーニング等の工程を順次行う装置が広く知られている。

【0003】

電子写真感光体としては、アルミニウム等の導電性を有する基体上に、電荷を発生する電荷発生層と、電荷を輸送する電荷輸送層を積層する機能分離型の感光体、又は、電荷を発生する機能と電荷を輸送する機能を同一の層が果たす単層型感光体が知られている。

10

【0004】

例えば、特許文献1には、例えば、特許文献1には、電荷輸送層に、ブタジエンー量体系電荷輸送材料とヒンダードフェノール系酸化防止剤とヒンダードアミン系酸化防止剤とを含有する電子写真感光体が開示されている。

特許文献2には、感光層に、ブタジエン三量体系電荷輸送材料とフェノール系酸化防止剤とベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤とを含有する電子写真感光体が開示されている。

特許文献3には、最表面層に、ブタジエン系電荷輸送材料とヒンダードフェノール系酸化防止剤とを含有することを特徴とする感光体が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

20

【0005】

【特許文献1】特開平7-261414号公報

【特許文献2】特開2010-211057号公報

【特許文献3】特開2012-047959号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明の課題は、電荷発生材料と、一般式（CT1）で示される電荷輸送材料と、一般式（CT2）で示される電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種のみを含む電子写真感光体と、帯電手段と、光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置を提供することである。

30

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記課題は、以下の手段により解決される。

【0008】

<1>に係る発明は、

40

導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料、下記一般式（CT1）で示される電荷輸送材料、下記一般式（CT2）で示される電荷輸送材料、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂、並びに、分子量300以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種を含む感光層と、を有する電子写真感光体と、

前記電子写真感光体の表面を帯電する帯電手段と、

光源として発光ダイオードを有し、前記発光ダイオードによる露光により、帯電した前記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、

トナーを含む現像剤により、前記電子写真感光体の表面に形成された静電潜像を現像し

50

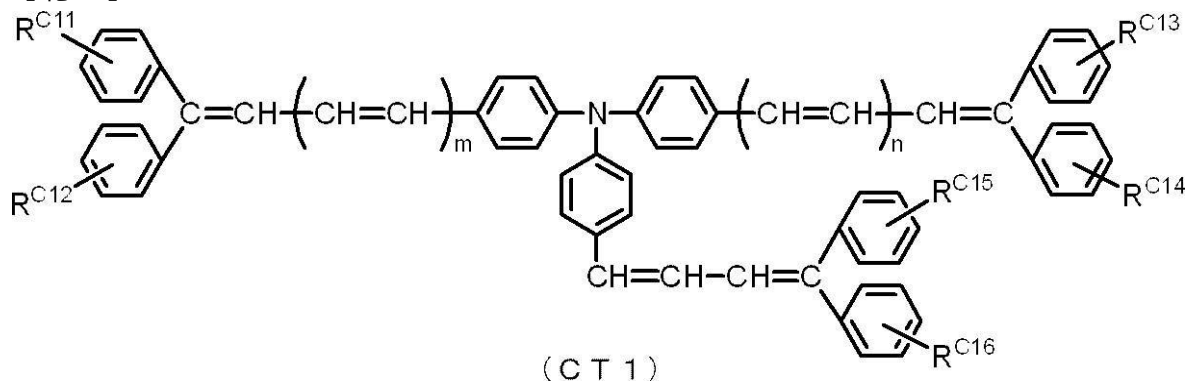
てトナー像を形成する現像手段と、

前記トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、

を備える画像形成装置。

【 0 0 0 9 】

【 化 1 】



10

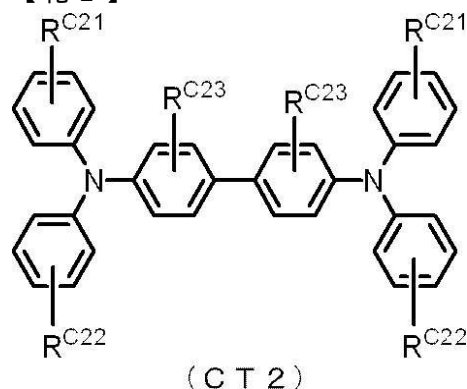
【 0 0 1 0 】

(一般式 (CT1) 中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 30 以下のアリール基を表し、隣接する 2 つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。n 及び m は、各々独立に、0、1 又は 2 を表す。)

20

【 0 0 1 1 】

【 化 2 】



30

【 0 0 1 2 】

(一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

【 0 0 1 3 】

< 2 > に係る発明は、

前記一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子を表し、m 及び n が 1 を表す < 1 > に記載の画像形成装置。

40

【 0 0 1 4 】

< 3 > に係る発明は、

前記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料において、 R^{C21} 、及び R^{C23} が水素原子を表し、 R^{C22} が炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す < 1 > 又は < 2 > に記載の画像形成装置。

【 0 0 1 5 】

< 4 > に係る発明は、

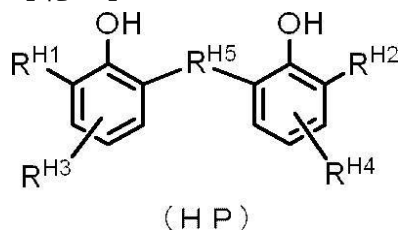
前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤が、下記一般式 (HP) で示される酸化防止剤

50

である $\leq 1 \geq \sim \leq 3 \geq$ のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【0016】

【化3】



【0017】

(一般式(HP)中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数4以上8以下の分岐状のアルキル基を表す。 R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数1以上10以下のアルキル基を表す。 R^{H5} は、炭素数1以上10以下のアルキレン基を表す。)

10

【0018】

$\leq 5 \geq$ に係る発明は、

前記一般式(HP)で示される酸化防止剤において、 R^{H1} 、及び R^{H2} がtert-ブチル基を表す $\leq 4 \geq$ に記載の画像形成装置。

【0019】

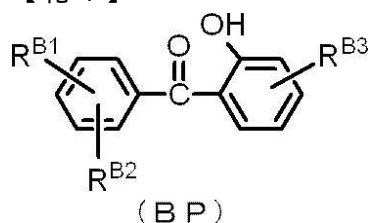
$\leq 6 \geq$ に係る発明は、

前記ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、下記一般式(BP)で示される紫外線吸収剤である $\leq 1 \geq \sim \leq 5 \geq$ のいずれか1項に記載の画像形成装置。

20

【0020】

【化4】



【0021】

(一般式(BP)中、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上10以下のアルキル基、炭素数1以上10以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上10以下のアリアル基を表す。ただし、 R^{B3} は水酸基を表してもよい。)

30

【0022】

$\leq 7 \geq$ に係る発明は、

前記一般式(BP)で示されるベンゾフェノン系紫外線吸収剤において、 R^{B1} 、及び R^{B2} が水素原子を表し、 R^{B3} が炭素数1以上4以下のアルコキシ基を表す $\leq 6 \geq$ に記載の画像形成装置。

40

【0023】

$\leq 8 \geq$ に係る発明は、

前記電荷発生材料が、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料である $\leq 1 \geq \sim \leq 7 \geq$ のいずれか1項に記載の画像形成装置。

【0024】

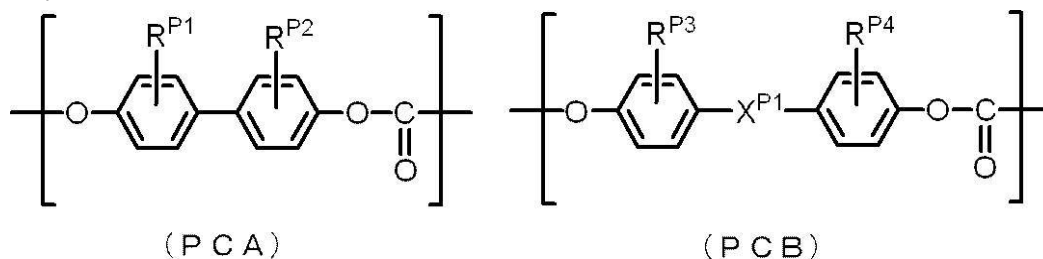
$\leq 9 \geq$ に係る発明は、

前記ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂が、下記一般式(PC A)で示される構造単位と、下記一般式(PC B)で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂である $\leq 1 \geq \sim \leq 8 \geq$ のいずれか1項に記載の画像形成装置。

【0025】

50

【化 5】



【0026】

(一般式 (PCA) 及び (PCB) 中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 6 以下のアルキル基、炭素数 5 以上 7 以下のシクロアルキル基、又は、炭素数 6 以上 12 以下のアリール基を表す。 X^{P1} は、フェニレン基、ピフェニレン基、ナフチレン基、アルキレン基、又は、シクロアルキレン基を表す。)

10

【0027】

< 10 > に係る発明は、

前記感光層が、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤と、を更に含む < 1 > ~ < 9 > のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【0028】

< 11 > に係る発明は、

導電性基体と、前記導電性基体上に配置された感光層であって、電荷発生材料、下記一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料、下記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂、並びに、分子量 300 以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種を含む感光層と、を有する電子写真感光体と、

20

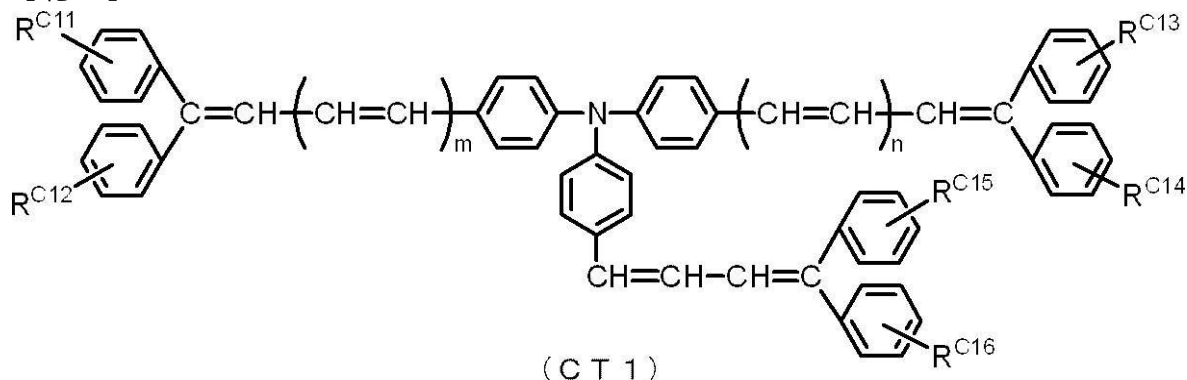
光源として発光ダイオードを有し、前記発光ダイオードによる露光により、帯電した前記電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、

を備え、画像形成装置に着脱するプロセスカートリッジ。

【0029】

30

【化 6】

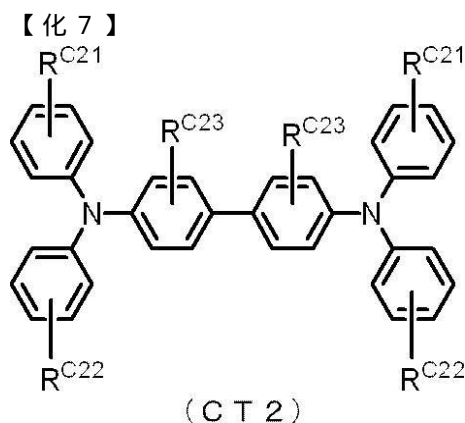


40

【0030】

(一般式 (CT1) 中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 30 以下のアリール基を表し、隣接する 2 つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。 n 及び m は、各々独立に、0、1 又は 2 を表す。)

【0031】



10

【0032】

(一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。)

【発明の効果】

【0033】

＜1＞に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、帯電手段と、光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

20

【0034】

＜2＞に係る発明によれば、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料が、例示化合物 (CT1-1) である電子写真感光体を備える画像形成装置に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

30

＜3＞に係る発明によれば、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料が、例示化合物 (CT2-1) である電子写真感光体を備える画像形成装置に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0035】

＜4＞、又は＜5＞に係る発明によれば、酸化防止剤が、構造式 (CAO-1) で示されるヒンダードフェノール系酸化防止剤である電子写真感光体を備える画像形成装置に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0036】

＜6＞、又は＜7＞に係る発明によれば、紫外線吸収剤が、構造式 (CUA-1) で示されるベンゾエート系紫外線吸収剤である電子写真感光体を備える画像形成装置に比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

40

【0037】

＜8＞に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも 1 種のみを含む電子写真感光体と、帯電手段と、光源として発光ダイオードを有する静電

50

潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置に比べ、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料を感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

【0038】

< 9 >に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種のみを含む電子写真感光体と、帯電手段と、光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段と、現像手段と、転写手段とを備える画像形成装置に比べ、ビスフェノールZの単独重合型ポリカーボネート樹脂として、一般式 (PCA) で示される構造単位と、下記一般式 (PCB) で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂を感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

10

【0039】

< 10 >に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種のみを含む電子写真感光体を備える画像形成装置に比べ、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤とを感光層に含むときでも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制した画像形成装置が提供される。

20

【0040】

< 11 >に係る発明によれば、電荷発生材料と、一般式 (CT1) で示される電荷輸送材料と、一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料と、ビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂とを含む感光層に、更に、酸化防止剤および紫外線吸収剤として、ヒンダードアミン系酸化防止剤およびベンゾエート系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種のみを含む電子写真感光体と、光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段とを備えるプロセスカートリッジに比べ、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、電子写真感光体が光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制したプロセスカートリッジが提供される。

30

【図面の簡単な説明】

【0041】

【図1】本実施形態に係る電子写真感光体の層構成の一例を示す概略部分断面図である。

【図2】本実施形態に係る画像形成装置の一例を示す概略構成図である。

【図3】本実施形態に係る画像形成装置の他の例を示す概略構成図である。

【発明を実施するための形態】

【0042】

以下、添付図面を参照しながら本発明の一例である実施形態について説明する。なお、図面中、同様の機能を有する要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。

【0043】

< 画像形成装置 / プロセスカートリッジ >

本実施形態に係る画像形成装置は、電子写真感光体と、電子写真感光体の表面を帯電する帯電手段と、光源として発光ダイオードを有し、発光ダイオードによる露光により、帯電した電子写真感光体の表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、トナーを含む現像剤により、電子写真感光体の表面に形成された静電潜像を現像してトナー像を形成する現像手段と、トナー像を記録媒体の表面に転写する転写手段と、を備える。

一方、電子写真感光体（以下「感光体」、又は「本実施形態に係る電子写真感光体」と

40

50

も称する)は、導電性基体と、導電性基体上に配置された感光層と、を有する。そして、感光層は、電荷発生材料と、一般式(C T 1)で示される電荷輸送材料(以下「ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)」とも称する)と、一般式(C T 2)で示される電荷輸送材料(以下「ベンジジン系電荷輸送材料(C T 2)」とも称する)と、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂(以下「B Pポリカーボネート樹脂」とも称する)と、分子量300以上のヒンダードフェノール系酸化防止剤(以下単に「ヒンダードフェノール系酸化防止剤」とも称する)およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種と、を含む。

【0044】

なお、感光層は、電荷発生層と電荷輸送層とを有する機能分離型の感光層であってもよいし、単層型の感光層であってもよい。機能分離型の感光層の場合、電荷発生層に電荷発生剤を含み、電荷輸送層に、ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)と、ベンジジン系電荷輸送材料(C T 2)と、B Pポリカーボネート樹脂と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種と、を含む。

【0045】

本実施形態に係る画像形成装置は、上記構成により、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制する。その理由は、以下に示すように推察される。

【0046】

まず、ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)は、電荷移動度が高く、電荷輸送能の高い感光層(又は電荷輸送層)を得る上で適している。一方で、ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)は、溶剤に対する溶解性が低い性質がある。このため、高い電荷輸送能を有する感光層を得るためには、ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)と共に、電荷移動度が比較的高く、溶剤に対する溶解性が高いベンジジン系電荷輸送材料(C T 2)を併用することがよい。

【0047】

しかし、ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)及びベンジジン系電荷輸送材料(C T 2)を共に含む感光層を有する感光体を使用し、同一画像を連続出力(例えば3000枚連続出力)した後に、例えば、全面ハーフトーン画像を出力すると、同一画像出力により連続露光された部分の感光体の表面電位が低下し、濃度が濃くなる「焼付きゴースト」と称する画像欠陥(ポジゴースト)が発生してしまうことがある。

また、感光体を交換するとき等に、感光体が室内光又は太陽光等に光暴露されると、光暴露された部分の感光体の帯電性が低下し、その後、全面ハーフトーン画像を出力すると、光暴露された部分の画像濃度が濃く浮き出る「光疲労」と称する画像欠陥が生じてしまう。

【0048】

「焼付きゴースト」及び「光疲労」と称される画像欠陥が生じる原因は、同一画像の連続出力および光暴露により、感光層中の電荷発生材料から電荷輸送材料への電荷の注入、および電荷輸送材料間の電荷の移動に預かる電子の非局在化領域において、電子が励起されやすい状態が生じることにより発生するためと考えられる。つまり、この画像欠陥は、電荷発生および電荷注入が活性化されることにより、同一画像の連続出力により連続して露光された領域、および光暴露された領域の帯電電位が低下し、画像の濃度上昇が生じることにより発生すると考えられる。

そして、この帯電電位の低下による画像の濃度上昇は、感光層がブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)及びベンジジン系電荷輸送材料(C T 2)を共に含有する場合に、特に顕著となる。これは、ブタジエン系電荷輸送材料(C T 1)が構造上高い電荷輸送能力を有するが故に、分子内の電子の非局在化領域が大きく、ベンジジン系電荷輸送材料(C T 2)及び電荷発生材料との間で相互作用を生じ、同一画像の連続出力および光暴露によって、帯電電位の低下が顕著に生じるためと考えられる。

【 0 0 4 9 】

更に、結着樹脂として、ＢＰポリカーボネート樹脂を含む感光層は、耐摩耗性が向上し、感光体の長寿命化が図れる。しかし、結着樹脂として、ＢＰポリカーボネート樹脂を含む感光層を有する感光体でも、特に、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じる。ＢＰポリカーボネート樹脂のビフェニル骨格のベンゼン環は、電荷輸送材料と相互作用することにより、電荷のトラップサイト（電荷が蓄積され易い領域）として働き易くなると考えられる。この電荷のトラップサイトにより、感光層中で電荷が過剰に蓄積されると、帯電後、感光体の表面に蓄積された電荷と相殺されるため、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じると考えられる。

【 0 0 5 0 】

加えて、感光体に静電潜像を形成させる静電潜像形成手段の光源として、発光ダイオードを用いた場合、光源としてレーザーを用いる場合に比べ、装置の小型化及び低価格化が図れる。しかし、レーザーに比べて、発光ダイオードは発生する光量が小さいため、発光ダイオードを有する静電潜像形成手段を感光体の表面近くに配置する。これに伴い、発光ダイオードの感光体表面の露光位置から離れて、現像手段が配置され、露光による静電潜像を形成してから現像するまでの時間（つまり、露光から現像までの時間〔感光体の表面が、露光光が照射された位置から現像領域に至るまでの間の時間〕）が長くなる傾向がある。具体的には、露光から現像までの時間が０．１秒以上０．５秒以下の範囲と長くなる傾向がある。その結果、感光体の感光層の暗減衰により、同一画像の連続出力により連続して露光された領域、および光暴露された領域の帯電電位の低下が更に生じ易くなり、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じると考えられる。

【 0 0 5 1 】

これに対して、ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）及びベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）と、ＢＰポリカーボネート樹脂とを共に含む感光層に、更に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤を含有させると、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が抑制される。これは、ヒンダードフェノール系酸化防止剤が、電子の非局在化領域との間で電荷の授受等の相互作用を生じさせ、同一画像の連続出力および光暴露による電子の非局在化領域において、電子のエネルギー状態の変化を抑制すると考えられるためである。そして、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の分子量を３００以上とすると、感光層を形成するときの乾燥工程において、ヒンダードフェノール系酸化防止剤が揮発することが抑制される。つまり、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の分子量を３００以上とすると、感光層中に上記機能を発現する量でヒンダードフェノール系酸化防止剤が残留すると考えられる。

【 0 0 5 2 】

一方、ブタジエン系電荷輸送材料（ＣＴ１）及びベンジジン系電荷輸送材料（ＣＴ２）と、ＢＰポリカーボネート樹脂とを共に含む感光層に、更に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤を含有させても、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が抑制される。これは、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤が、同一画像の連続出力および光暴露によって、感光層に受ける光エネルギーを吸収し、電子の非局在化領域において、電子のエネルギー状態の変化を抑制するためと考えられる。

【 0 0 5 3 】

更に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、ＢＰポリカーボネート樹脂のビフェニル骨格のベンゼン環と電荷輸送材料とに作用し、ビフェニル骨格のベンゼン環と電荷輸送材料との相互作用による電荷のトラップサイトの形成が抑制されることが考えられる。このため、ビフェニル骨格のベンゼン環と電荷輸送材料との相互作用による電荷のトラップサイトに起因して生じる感光層中の電荷の過剰な蓄積が抑制されることが考えられる。

【 0 0 5 4 】

加えて、感光体を上記構成とすることにより、光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段を備えることにより、露光から現像までの時間が長くなっても、同一画像の

連続出力および光暴露による帯電電位の低下が生じ難くなる。

【 0 0 5 5 】

以上から、本実施形態に係る画像形成装置は、光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段を備え、露光から現像までの時間が例えば 0 . 1 秒以上 0 . 5 秒以下と長くなっても、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制すると推測される。

【 0 0 5 6 】

そして、本実施形態に係る電子写真感光体では、結着樹脂として、B P ポリカーボネート樹脂を感光層に含むため、感光層の耐摩耗性が向上し、長寿命化が実現される。

【 0 0 5 7 】

また、電荷発生材料として、電荷発生効率の高いヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料を感光層に含む場合、発生する電荷量が多いため、同一画像の連続出力および光暴露による帯電電位の低下が顕著になり、焼付きゴースト及び光疲労が発生し易くなる。しかし、本実施形態に係る電子写真感光体では、ヒドロキシガリウムフタロシアニンを感光層に含む場合でも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制する。

【 0 0 5 8 】

更に、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤とを感光層に含む場合、感光層の耐摩耗性が向上し、感光体の長寿命化が図れる。一方で、フッ素含有分散剤を感光層に含むと、フッ素含有分散剤が電荷のトラップサイト（電荷が蓄積され易い領域）として働き易くなると考えられる。この電荷のトラップサイトにより、感光層中で電荷が過剰に蓄積されると、帯電後、感光体の表面に蓄積された電荷と相殺されるため、「焼付きゴースト」及び「光疲労」が顕著に生じると考えられる。しかし、本実施形態に係る電子写真感光体では、フッ素含有樹脂粒子と、フッ素含有分散剤とを感光層に含む場合でも、同一画像を連続して出力したときに生じる焼付きゴーストの発生と共に、光暴露されたときに生じる光疲労の発生を抑制する。

【 0 0 5 9 】

ここで、本実施形態に係る画像形成装置は、記録媒体の表面に転写されたトナー像を定着する定着手段を備える装置；電子写真感光体の表面に形成されたトナー像を直接記録媒体に転写する直接転写方式の装置；電子写真感光体の表面に形成されたトナー像を中間転写体の表面に一次転写し、中間転写体の表面に転写されたトナー像を記録媒体の表面に二次転写する中間転写方式の装置；トナー像の転写後、帯電前の電子写真感光体の表面をクリーニングするクリーニング手段を備えた装置；トナー像の転写後、帯電前に像保持体の表面に除電光を照射して除電する除電手段を備える装置；電子写真感光体の温度を上昇させ、相対湿度を低減させるための電子写真感光体加熱部材を備える装置等の周知の画像形成装置が適用される。

【 0 0 6 0 】

中間転写方式の装置の場合、転写手段は、例えば、表面にトナー像が転写される中間転写体と、像保持体の表面に形成されたトナー像を中間転写体の表面に一次転写する一次転写手段と、中間転写体の表面に転写されたトナー像を記録媒体の表面に二次転写する二次転写手段と、を有する構成が適用される。

【 0 0 6 1 】

本実施形態に係る画像形成装置は、乾式現像方式の画像形成装置、湿式現像方式（液体現像剤を利用した現像方式）の画像形成装置のいずれであってもよい。

【 0 0 6 2 】

なお、本実施形態に係る画像形成装置において、例えば、電子写真感光体を備える部分が、画像形成装置に対して脱着されるカートリッジ構造（プロセスカートリッジ）であってもよい。プロセスカートリッジとしては、例えば、本実施形態に係る電子写真感光体と光源として発光ダイオードを有する静電潜像形成手段とを備えるプロセスカートリッジが好適に用いられる。なお、プロセスカートリッジには、電子写真感光体及び静電潜像形成

10

20

30

40

50

手段以外に、例えば、帯電手段、現像手段、転写手段からなる群から選択される少なくとも一つを備えてもよい。

【0063】

以下、本実施形態に係る画像形成装置の一例を示すが、これに限定されるわけではない。なお、図に示す主要部を説明し、その他はその説明を省略する。

【0064】

図2は、本実施形態に係る画像形成装置の一例を示す概略構成図である。

本実施形態に係る画像形成装置100は、図2に示すように、電子写真感光体7を備えるプロセスカートリッジ300と、転写装置40（一次転写装置）と、中間転写体50とを備える。なお、画像形成装置100において、露光装置9はプロセスカートリッジ300の開口部から電子写真感光体7に露光し得る位置に配置されており、転写装置40は中間転写体50を介して電子写真感光体7に対向する位置に配置されており、中間転写体50はその一部が電子写真感光体7に接触して配置されている。図示しないが、中間転写体50に転写されたトナー像を記録媒体（例えば用紙）に転写する二次転写装置も有している。なお、中間転写体50、転写装置40（一次転写装置）、及び二次転写装置（不図示）が転写手段の一例に相当する。

【0065】

図2におけるプロセスカートリッジ300は、ハウジング内に、電子写真感光体7、帯電装置8（帯電手段の一例）、露光装置9（静電潜像形成手段の一例）と、現像装置11（現像手段の一例）、及びクリーニング装置13（クリーニング手段の一例）を一体に支持している。クリーニング装置13は、クリーニングブレード（クリーニング部材の一例）131を有しており、クリーニングブレード131は、電子写真感光体7の表面に接触するように配置されている。なお、クリーニング部材は、クリーニングブレード131の態様ではなく、導電性又は絶縁性の繊維状部材であってもよく、これを単独で、又はクリーニングブレード131と併用してもよい。

【0066】

なお、図2には、画像形成装置として、潤滑材14を電子写真感光体7の表面に供給する繊維状部材132（ロール状）、及び、クリーニングを補助する繊維状部材133（平ブラシ状）を備えた例を示してあるが、これらは必要に応じて配置される。

【0067】

以下、本実施形態に係る画像形成装置の各構成について説明する。

【0068】

<電子写真感光体>

以下、本実施形態に係る電子写真感光体について図面を参照して説明する。

図1は、本実施形態に係る電子写真感光体7Aの層構成の一例を示す概略部分断面図である。図1に示す電子写真感光体7Aは、導電性基体4上に、下引層1、電荷発生層2及び電荷輸送層3がこの順序で積層された構造を有する。そして、電荷発生層2及び電荷輸送層3が感光層5を構成している。

【0069】

なお、電子写真感光体7Aは、下引層1が設けられていない層構成であってもよい。また、電子写真感光体7Aは、電荷輸送層3上に、更に保護層が設けられた層構成であってもよい。また、各電子写真感光体7Aは、電荷発生層2と電荷輸送層3との機能が一体化した単層型感光層であってもよい。

【0070】

以下、電子写真感光体の各要素について説明する。なお、電子写真感光体の各要素の符号は、符号は省略して説明する。

【0071】

（導電性基体）

導電性基体としては、例えば、金属（アルミニウム、銅、亜鉛、クロム、ニッケル、モリブデン、バナジウム、インジウム、金、白金等）又は合金（ステンレス鋼等）を含む金

10

20

30

40

50

属板、金属ドラム、及び金属ベルト等が挙げられる。また、導電性基体としては、例えば、導電性化合物（例えば導電性ポリマー、酸化インジウム等）、金属（例えばアルミニウム、パラジウム、金等）又は合金を塗布、蒸着又はラミネートした紙、樹脂フィルム、ベルト等も挙げられる。ここで、「導電性」とは体積抵抗率が 10^{-13} c m 未満であることをいう。

【0072】

導電性基体の表面は、電子写真感光体がレーザプリンタに使用される場合、レーザ光を照射する際に生じる干渉縞を抑制する目的で、中心線平均粗さ R_a で $0.04\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下に粗面化されていることが好ましい。なお、非干渉光を光源に用いる場合、干渉縞防止の粗面化は、特に必要ないが、導電性基体の表面の凹凸による欠陥の発生を抑制するため、より長寿命化に適する。

10

【0073】

粗面化の方法としては、例えば、研磨剤を水に懸濁させて導電性基体に吹き付けることによって行う湿式ホーニング、回転する砥石に導電性基体を圧接し、連続的に研削加工を行うセンタレス研削、陽極酸化処理等が挙げられる。

【0074】

粗面化の方法としては、導電性基体の表面を粗面化することなく、導電性又は半導電性粉体を樹脂中に分散させて、導電性基体の表面上に層を形成し、その層中に分散させる粒子により粗面化する方法も挙げられる。粗面化のための層としては、後述の下引層を用いることも可能である。

20

【0075】

陽極酸化による粗面化処理は、金属製（例えばアルミニウム製）の導電性基体を陽極とし電解質溶液中で陽極酸化することにより導電性基体の表面に酸化膜を形成するものである。電解質溶液としては、例えば、硫酸溶液、シュウ酸溶液等が挙げられる。しかし、陽極酸化により形成された多孔質陽極酸化膜は、そのままの状態では化学的に活性であり、汚染され易く、環境による抵抗変動も大きい。そこで、多孔質陽極酸化膜に対して、酸化膜の微細孔を加圧水蒸気又は沸騰水中（ニッケル等の金属塩を加えてもよい）で水和反応による体積膨張でふさぎ、より安定な水和酸化物に変える封孔処理を行うことが好ましい。

【0076】

陽極酸化膜の膜厚は、例えば、 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $15\text{ }\mu\text{m}$ 以下が好ましい。この膜厚が上記範囲内にあると、注入に対するバリア性が発揮される傾向があり、また繰り返し使用による残留電位の上昇が抑えられる傾向にある。

30

【0077】

導電性基体には、酸性処理液による処理又はペーマイト処理を施してもよい。

酸性処理液による処理は、例えば、以下のようにして実施される。まず、リン酸、クロム酸及びフッ酸を含む酸性処理液を調製する。酸性処理液におけるリン酸、クロム酸及びフッ酸の配合割合は、例えば、リン酸が $10\text{ 質量}\%$ 以上 $11\text{ 質量}\%$ 以下の範囲、クロム酸が $3\text{ 質量}\%$ 以上 $5\text{ 質量}\%$ 以下の範囲、フッ酸が $0.5\text{ 質量}\%$ 以上 $2\text{ 質量}\%$ 以下の範囲であって、これらの酸全体の濃度は $13.5\text{ 質量}\%$ 以上 $18\text{ 質量}\%$ 以下の範囲がよい。処理温度は例えば 42 以上 48 以下が好ましい。被膜の膜厚は、 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $15\text{ }\mu\text{m}$ 以下が好ましい。

40

【0078】

ペーマイト処理は、例えば 90 以上 100 以下の純水中に 5 分から 60 分間浸漬すること、又は 90 以上 120 以下の加熱水蒸気に 5 分から 60 分間接触させて行う。被膜の膜厚は、 $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $5\text{ }\mu\text{m}$ 以下が好ましい。これをさらにアジピン酸、硼酸、硼酸塩、磷酸塩、フタル酸塩、マレイン酸塩、安息香酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩等の被膜溶解性の低い電解質溶液を用いて陽極酸化処理してもよい。

【0079】

（下引層）

50

下引層は、例えば、無機粒子と結着樹脂とを含む層である。

【0080】

無機粒子としては、例えば、粉体抵抗（体積抵抗率） 10^2 cm以上 10^{11} cm以下の無機粒子が挙げられる。

これらの中でも、上記抵抗値を有する無機粒子としては、例えば、酸化錫粒子、酸化チタン粒子、酸化亜鉛粒子、酸化ジルコニウム粒子等の金属酸化物粒子がよく、特に、酸化亜鉛粒子が好ましい。

【0081】

無機粒子のBET法による比表面積は、例えば、 $10\text{ m}^2/\text{g}$ 以上がよい。

無機粒子の体積平均粒径は、例えば、 50 nm 以上 2000 nm 以下（好ましくは 60 nm 以上 1000 nm 以下）がよい。 10

【0082】

無機粒子の含有量は、例えば、結着樹脂に対して、 $10\text{ 質量}\%$ 以上 $80\text{ 質量}\%$ 以下であることが好ましく、より好ましくは $40\text{ 質量}\%$ 以上 $80\text{ 質量}\%$ 以下である。

【0083】

無機粒子は、表面処理が施されていてもよい。無機粒子は、表面処理の異なるもの、又は、粒子径の異なるものを2種以上混合して用いてもよい。

【0084】

表面処理剤としては、例えば、シランカップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミニウム系カップリング剤、界面活性剤等が挙げられる。特に、シランカップリング剤が好ましく、アミノ基を有するシランカップリング剤がより好ましい。 20

【0085】

アミノ基を有するシランカップリング剤としては、例えば、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0086】

シランカップリング剤は、2種以上混合して使用してもよい。例えば、アミノ基を有するシランカップリング剤と他のシランカップリング剤とを併用してもよい。その他のシランカップリング剤としては、例えば、ビニルトリメトキシシラン、3-メタクリルオキシプロピル-トリシ(2-メトキシエトキシ)シラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。 30

【0087】

表面処理剤による表面処理方法は、公知の方法であればいかなる方法でもよく、乾式法又は湿式法のいずれでもよい。 40

【0088】

表面処理剤の処理量は、例えば、無機粒子に対して $0.5\text{ 質量}\%$ 以上 $10\text{ 質量}\%$ 以下が好ましい。

【0089】

ここで、下引層は、無機粒子と共に電子受容性化合物（アクセプター化合物）を含有することが、電気特性の長期安定性、キャリアブロック性が高まる観点からよい。

【0090】

電子受容性化合物としては、例えば、クロラニル、プロモアニル等のキノン系化合物；テトラシアノキノジメタン系化合物；2,4,7-トリニトロフルオレノン、2,4,5 50

、7-テトラニトロ-9-フルオレノン等のフルオレノン化合物；2-(4-ビフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、2,5-ビス(4-ナフチル)-1,3,4-オキサジアゾール、2,5-ビス(4-ジエチルアミノフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール等のオキサジアゾール系化合物；キサントン系化合物；チオフェン化合物；3,3',5,5'-テトラ-t-ブチルジフェノキノン等のジフェノキノン化合物；等の電子輸送性物質等が挙げられる。

特に、電子受容性化合物としては、アントラキノン構造を有する化合物が好ましい。アントラキノン構造を有する化合物としては、例えば、ヒドロキシアントラキノン化合物、アミノアントラキノン化合物、アミノヒドロキシアントラキノン化合物等が好ましく、具体的には、例えば、アントラキノン、アリザリン、キニザリン、アントラルフィン、ブルプリン等が好ましい。

10

【0091】

電子受容性化合物は、下引層中に無機粒子と共に分散して含まれていてもよいし、無機粒子の表面に付着した状態で含まれていてもよい。

【0092】

電子受容性化合物を無機粒子の表面に付着させる方法としては、例えば、乾式法、又は、湿式法が挙げられる。

【0093】

乾式法は、例えば、無機粒子をせん断力の大きなミキサ等で攪拌しながら、直接又は有機溶媒に溶解させた電子受容性化合物を滴下、乾燥空気や窒素ガスとともに噴霧させて、電子受容性化合物を無機粒子の表面に付着する方法である。電子受容性化合物の滴下又は噴霧するときは、溶剤の沸点以下の温度で行うことがよい。電子受容性化合物を滴下又は噴霧した後、更に100℃以上で焼き付けを行ってもよい。焼き付けは電子写真特性が得られる温度、時間であれば特に制限されない。

20

【0094】

湿式法は、例えば、攪拌、超音波、サンドミル、アトライター、ボールミル等により、無機粒子を溶剤中に分散しつつ、電子受容性化合物を添加し、攪拌又は分散した後、溶剤除去して、電子受容性化合物を無機粒子の表面に付着する方法である。溶剤除去方法は、例えば、ろ過又は蒸留により除去される。溶剤除去後には、更に100℃以上で焼き付けを行ってもよい。焼き付けは電子写真特性が得られる温度、時間であれば特に限定されない。湿式法においては、電子受容性化合物を添加する前に無機粒子の含有水分を除去してもよく、その例として溶剤中で攪拌加熱しながら除去する方法、溶剤と共沸させて除去する方法が挙げられる。

30

【0095】

なお、電子受容性化合物の付着は、表面処理剤による表面処理を無機粒子に施す前又は後に行ってもよく、電子受容性化合物の付着と表面処理剤による表面処理と同時に行ってもよい。

【0096】

電子受容性化合物の含有量は、例えば、無機粒子に対して0.01質量%以上20質量%以下がよく、好ましくは0.01質量%以上10質量%以下である。

40

【0097】

下引層に用いる結着樹脂としては、例えば、アセタール樹脂(例えばポリビニルブチラール等)、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、カゼイン樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース樹脂、ゼラチン、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸樹脂、シリコーン樹脂、シリコーン-アルキッド樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、エポキシ樹脂等の公知の高分子化合物；ジルコニウムキレート化合物；チタニウムキレート化合物；アルミニウムキレート化合物；チタニウムアルコキシド化合物；有機チタニウム化合物；シランカップリング剤等の公

50

知の材料が挙げられる。

下引層に用いる結着樹脂としては、例えば、電荷輸送性基を有する電荷輸送性樹脂、導電性樹脂（例えばポリアニリン等）等も挙げられる。

【0098】

これらの中でも、下引層に用いる結着樹脂としては、上層の塗布溶剤に不溶な樹脂が好適であり、特に、尿素樹脂、フェノール樹脂、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂；ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂及びポリビニルアセタール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種の樹脂と硬化剤との反応により得られる樹脂が好適である。

10

これら結着樹脂を2種以上組み合わせて使用する場合には、その混合割合は、必要に応じて設定される。

【0099】

下引層には、電気特性向上、環境安定性向上、画質向上のために種々の添加剤を含んでもよい。

添加剤としては、多環縮合系、アゾ系等の電子輸送性顔料、ジルコニウムキレート化合物、チタニウムキレート化合物、アルミニウムキレート化合物、チタニウムアルコキシド化合物、有機チタニウム化合物、シランカップリング剤等の公知の材料が挙げられる。シランカップリング剤は前述のように無機粒子の表面処理に用いられるが、添加剤として更に下引層に添加してもよい。

20

【0100】

添加剤としてのシランカップリング剤としては、例えば、ビニルトリメトキシシラン、3-メタクリルオキシプロピル-トリシラン（2-メトキシエトキシ）シラン、2-（3,4-エポキシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-2-（アミノエチル）-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-2-（アミノエチル）-3-アミノプロピルメチルメトキシシラン、N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。

【0101】

30

ジルコニウムキレート化合物としては、例えば、ジルコニウムブトキシド、ジルコニウムアセト酢酸エチル、ジルコニウムトリエタノールアミン、アセチルアセトネートジルコニウムブトキシド、アセト酢酸エチルジルコニウムブトキシド、ジルコニウムアセテート、ジルコニウムオキサレート、ジルコニウムラクテート、ジルコニウムホスホネート、オクタン酸ジルコニウム、ナフテン酸ジルコニウム、ラウリン酸ジルコニウム、ステアリン酸ジルコニウム、イソステアリン酸ジルコニウム、メタクリレートジルコニウムブトキシド、ステアレートジルコニウムブトキシド、イソステアレートジルコニウムブトキシド等が挙げられる。

【0102】

チタニウムキレート化合物としては、例えば、テトライソプロピルチタネート、テトラノルマルブチルチタネート、ブチルチタネートダイマー、テトラ（2-エチルヘキシル）チタネート、チタンアセチルアセトネート、ポリチタンアセチルアセトネート、チタンオクチレングリコレート、チタンラクテートアンモニウム塩、チタンラクテート、チタンラクテートエチルエステル、チタントリエタノールアミネート、ポリヒドロキシチタンステアレート等が挙げられる。

40

【0103】

アルミニウムキレート化合物としては、例えば、アルミニウムイソプロピレート、モノブトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムブチレート、ジエチルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムトリシラン（エチルアセトアセテート）等が挙げられる。

50

【0104】

これらの添加剤は、単独で、又は複数の化合物の混合物若しくは重縮合物として用いてもよい。

【0105】

下引層は、ピッカース硬度が35以上であることがよい。

下引層の表面粗さ(十点平均粗さ)は、モアレ像抑制のために、使用される露光用レーザー波長の $1/4n$ (n は上層の屈折率)から $1/2$ までに調整されていることがよい。

表面粗さ調整のために下引層中に樹脂粒子等を添加してもよい。樹脂粒子としてはシリコーン樹脂粒子、架橋型ポリメタクリル酸メチル樹脂粒子等が挙げられる。また、表面粗さ調整のために下引層の表面を研磨してもよい。研磨方法としては、バフ研磨、サンドブラスト処理、湿式ホーニング、研削処理等が挙げられる。

10

【0106】

下引層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた下引層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥し、必要に応じて加熱することで行う。

【0107】

下引層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、公知の有機溶剤、例えば、アルコール系溶剤、芳香族炭化水素溶剤、ハロゲン化炭化水素溶剤、ケトン系溶剤、ケトンアルコール系溶剤、エーテル系溶剤、エステル系溶剤等が挙げられる。

20

これらの溶剤として具体的には、例えば、メタノール、エタノール、 n -プロパノール、 i so-プロパノール、 n -ブタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸 n -ブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム、クロロベンゼン、トルエン等の通常の有機溶剤が挙げられる。

【0108】

下引層形成用塗布液を調製するときの無機粒子の分散方法としては、例えば、ロールミル、ボールミル、振動ボールミル、アトライター、サンドミル、コロイドミル、ペイントシェーカー等の公知の方法が挙げられる。

【0109】

下引層形成用塗布液を導電性基体上に塗布する方法としては、例えば、ブレード塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、浸漬塗布法、ビード塗布法、エアナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

30

【0110】

下引層の膜厚は、例えば、好ましくは $1.5\mu\text{m}$ 以上、より好ましくは $1.8\mu\text{m}$ 以上 $5.0\mu\text{m}$ 以下の範囲内に設定される。

【0111】

(中間層)

図示は省略するが、下引層と感光層との間に中間層をさらに設けてもよい。

中間層は、例えば、樹脂を含む層である。中間層に用いる樹脂としては、例えば、アセタール樹脂(例えばポリビニルブチラール等)、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、カゼイン樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース樹脂、ゼラチン、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸樹脂、シリコーン樹脂、シリコーン-アルキッド樹脂、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂等の高分子化合物が挙げられる。

40

中間層は、有機金属化合物を含む層であってもよい。中間層に用いる有機金属化合物としては、ジルコニウム、チタニウム、アルミニウム、マンガン、ケイ素等の金属原子を含有する有機金属化合物等が挙げられる。

これらの中間層に用いる化合物は、単独で又は複数の化合物の混合物若しくは重縮合物

50

として用いてもよい。

【0112】

これらの中でも、中間層は、ジルコニウム原子又はケイ素原子を含有する有機金属化合物を含む層であることが好ましい。

【0113】

中間層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた中間層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥、必要に応じて加熱することで行う。

中間層を形成する塗布方法としては、浸漬塗布法、突き上げ塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、ブレード塗布法、ナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が

10

【0114】

中間層の膜厚は、例えば、好ましくは0.1 μm以上3 μm以下の範囲に設定される。なお、中間層を下引層として使用してもよい。

【0115】

(電荷発生層)

電荷発生層は、例えば、電荷発生材料と結着樹脂とを含む層である。また、電荷発生層は、電荷発生材料の蒸着層であってもよい。電荷発生材料の蒸着層は、LED (Light Emitting Diode)、有機EL (Electro-Luminescence) イメージアレイ等の非干渉性光源を用いる場合に好適である。

20

【0116】

電荷発生材料としては、ビスアゾ、トリスアゾ等のアゾ顔料；ジプロモアントアントロン等の縮環芳香族顔料；ペリレン顔料；ピロロピロール顔料；フタロシアニン顔料；酸化亜鉛；三方晶系セレン等が挙げられる。

【0117】

これらの中でも、近赤外域のレーザ露光に対応させるためには、電荷発生材料としては、金属フタロシアニン顔料、又は無金属フタロシアニン顔料を用いることが好ましい。具体的には、例えば、特開平5-263007号公報、特開平5-279591号公報等

30

【0118】

一方、近紫外域のレーザ露光に対応させるためには、電荷発生材料としては、ジプロモアントアントロン等の縮環芳香族顔料；チオインジゴ系顔料；ポルフィラジン化合物；酸化亜鉛；三方晶系セレン；特開2004-78147号公報、特開2005-181992号公報に開示されたビスアゾ顔料等が好ましい。

【0119】

450 nm以上780 nm以下に発光の中心波長があるLED、有機ELイメージアレイ等の非干渉性光源を用いる場合にも、上記電荷発生材料を用いてもよいが、解像度の観点より、感光層を20 μm以下の薄膜で用いるときには、感光層中の電界強度が高くなり、基体からの電荷注入による帯電低下、いわゆる黒点と呼ばれる画像欠陥を生じやすくなる。これは、三方晶系セレン、フタロシアニン顔料等のp-型半導体で暗電流を生じやすい電荷発生材料を用いたときに顕著となる。

40

【0120】

これに対し、電荷発生材料として、縮環芳香族顔料、ペリレン顔料、アゾ顔料等のn-型半導体を用いた場合、暗電流を生じ難く、薄膜にしても黒点と呼ばれる画像欠陥を抑制し得る。n-型の電荷発生材料としては、例えば、特開2012-155282号公報の段落[0288]～[0291]に記載された化合物(CG-1)～(CG-27)が挙げられるがこれに限られるものではない。

50

なお、n - 型の判定は、通常使用されるタイムオブフライト法を用い、流れる光電流の極性によって判定され、正孔よりも電子をキャリアとして流しやすいものをn - 型とする。

【0121】

これらの中でも、電荷発生材料としては、電荷発生効率の点で、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料であることが好ましく、V型のヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料がより好ましい。

特に、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料としては、例えば、600nm以上900nm以下の波長域での分光吸収スペクトルにおいて、810nm以上839nm以下の範囲に最大ピーク波長を有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料がより優れた分散性が得られる観点から好ましい。

10

【0122】

また、上記の810nm以上839nm以下の範囲に最大ピーク波長を有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料は、平均粒径が特定の範囲であり、且つ、BET比表面積が特定の範囲であることが好ましい。具体的には、平均粒径が0.20μm以下であることが好ましく、0.01μm以上0.15μm以下であることがより好ましい。一方、BET比表面積が45m²/g以上であることが好ましく、50m²/g以上であることがより好ましく、55m²/g以上120m²/g以下であることが特に好ましい。平均粒径は、体積平均粒径(d₅₀平均粒径)でレーザ回折分散乱式粒度分布測定装置(LA-700、堀場製作所製)にて測定した値である。また、BET式比表面積測定器(島津製作所製：フローソーブII2300)を用い窒素置換法にて測定した値である。

20

【0123】

ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料の最大粒径(一次粒子径の最大値)は、1.2μm以下であることが好ましく、1.0μm以下であることがより好ましく、更に好ましくは0.3μm以下である。

【0124】

ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料は、平均粒径が0.2μm以下、最大粒径が1.2μm以下であり、且つ、比表面積値が45m²/g以上であることが好ましい。

【0125】

ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料は、CuK 特性X線を用いたX線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角度(2θ ± 0.2°)が少なくとも7.3°, 16.0°, 24.9°, 28.0°に回折ピークを有するV型であることが好ましい。

30

【0126】

電荷発生材料は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0127】

電荷発生層に用いる結着樹脂としては、広範な絶縁性樹脂から選択され、また、結着樹脂としては、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリビニルアントラセン、ポリビニルピレン、ポリシラン等の有機光導電性ポリマーから選択してもよい。

結着樹脂としては、例えば、ポリビニルブチラル樹脂、ポリアリレート樹脂(ビスフェノール類と芳香族2価カルボン酸の重縮合体等)、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノキシ樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、ポリビニルピリジン樹脂、セルロース樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、カゼイン、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂等が挙げられる。ここで、「絶縁性」とは、体積抵抗率が10¹³Ω・cm以上であることをいう。

40

これらの結着樹脂は1種を単独で又は2種以上を混合して用いられる。

【0128】

なお、電荷発生材料と結着樹脂の配合比は、質量比で10:1から1:10までの範囲内であることが好ましい。

【0129】

50

電荷発生層には、その他、周知の添加剤が含まれていてもよい。

【0130】

電荷発生層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた電荷発生層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥し、必要に応じて加熱することで行う。なお、電荷発生層の形成は、電荷発生材料の蒸着により行ってもよい。電荷発生層の蒸着による形成は、特に、電荷発生材料として縮環芳香族顔料、ペリレン顔料を利用する場合に好適である。

【0131】

電荷発生層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、メタノール、エタノール、n - プロパノール、n - ブタノール、ベンジルアルコール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸n - ブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メチレンクロライド、クロロホルム、クロロベンゼン、トルエン等が挙げられる。これら溶剤は、1種を単独で又は2種以上を混合して用いる。

【0132】

電荷発生層形成用塗布液中に粒子（例えば電荷発生材料）を分散させる方法としては、例えば、ボールミル、振動ボールミル、アトライター、サンドミル、横型サンドミル等のメディア分散機や、攪拌、超音波分散機、ロールミル、高圧ホモジナイザー等のメディアレス分散機が利用される。高圧ホモジナイザーとしては、例えば、高圧状態で分散液を液 - 液衝突や液 - 壁衝突させて分散する衝突方式や、高圧状態で微細な流路を貫通させて分散する貫通方式等が挙げられる。

なお、この分散の際、電荷発生層形成用塗布液中の電荷発生材料の平均粒径を0.5 μm以下、好ましくは0.3 μm以下、更に好ましくは0.15 μm以下にすることが有効である。

【0133】

電荷発生層形成用塗布液を下引層上（又は中間層上）に塗布する方法としては、例えばブレード塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、浸漬塗布法、ビード塗布法、エアナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

【0134】

電荷発生層の膜厚は、例えば、好ましくは0.1 μm以上5.0 μm以下、より好ましくは0.2 μm以上2.0 μm以下の範囲内に設定される。

【0135】

（電荷輸送層）

電荷輸送層は、例えば、電荷輸送材料と結着樹脂とを含む層である。

電荷輸送材料としては、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）及びベンジジン系電荷輸送材料（CT2）が適用される。そして、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）及びベンジジン系電荷輸送材料（CT2）を含む電荷輸送層には、更に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種を含む。更に、電荷輸送層には、フッ素含有樹脂粒子、およびフッ素含有分散剤を含んでもよい。

【0136】

- 電荷輸送材料 -

ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）について説明する。

ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）は、下記一般式（CT1）で示される電荷輸送材料である。

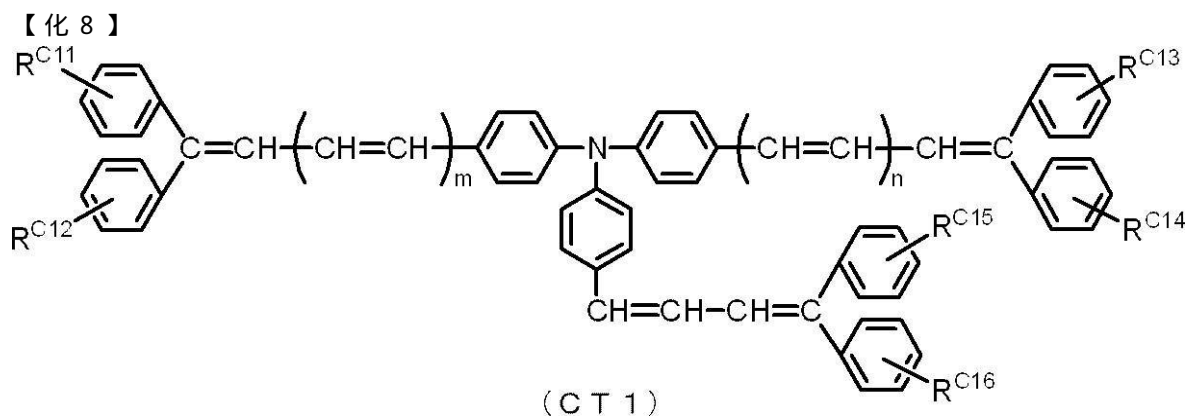
【0137】

10

20

30

40



10

【0138】

一般式 (CT1) 中、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 30 以下のアリール基を表し、隣接する 2 つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよい。

n 及び m は、各々独立に、0、1 又は 2 を表す。

【0139】

一般式 (CT1) において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。これらの中でも、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子が好ましく、塩素原子がより好ましい。

20

【0140】

一般式 (CT1) において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すアルキル基としては、炭素数 1 以上 20 以下（好ましくは 1 以上 6 以下、より好ましくは 1 以上 4 以下）の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、 n -ブチル基、 n -ペンチル基、 n -ヘキシル基、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基、 n -ノニル基、 n -デシル基、 n -ウンデシル基、 n -ドデシル基、 n -トリデシル基、 n -テトラデシル基、 n -ペンタデシル基、 n -ヘキサデシル基、 n -ヘプタデシル基、 n -オクタデシル基、 n -ノナデシル基、 n -イコシル基等が挙げられる。

30

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、 $tert$ -ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 $tert$ -ペンチル基、イソヘキシル基、 sec -ヘキシル基、 $tert$ -ヘキシル基、イソヘプチル基、 sec -ヘプチル基、 $tert$ -ヘプチル基、イソオクチル基、 sec -オクチル基、 $tert$ -オクチル基、イソノニル基、 sec -ノニル基、 $tert$ -ノニル基、イソデシル基、 sec -デシル基、 $tert$ -デシル基、イソウンデシル基、 sec -ウンデシル基、 $tert$ -ウンデシル基、ネオウンデシル基、イソドデシル基、 sec -ドデシル基、 $tert$ -ドデシル基、ネオドデシル基、イソトリデシル基、 sec -トリデシル基、 $tert$ -トリデシル基、ネオトリデシル基、イソテトラデシル基、 sec -テトラデシル基、 $tert$ -テトラデシル基、ネオテトラデシル基、1-イソブチル-4-エチルオクチル基、イソペンタデシル基、 sec -ペンタデシル基、 $tert$ -ペンタデシル基、ネオペンタデシル基、イソヘキサデシル基、 sec -ヘキサデシル基、 $tert$ -ヘキサデシル基、ネオヘキサデシル基、1-メチルペンタデシル基、イソヘプタデシル基、 sec -ヘプタデシル基、 $tert$ -ヘプタデシル基、ネオヘプタデシル基、イソオクタデシル基、 sec -オクタデシル基、 $tert$ -オクタデシル基、ネオオクタデシル基、イソノナデシル基、 sec -ノナデシル基、 $tert$ -ノナデシル基、ネオノナデシル基、1-メチルオクチル基、イソイコシル基、 sec -イコシル基、 $tert$ -イコシル基、ネオイコシル基等が挙げられる。

40

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロピル基等の低級

50

アルキル基が好ましい。

【0141】

一般式(CT1)において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すアルコキシ基としては、炭素数1以上20以下(好ましくは1以上6以下、より好ましくは1以上4以下)の直鎖状又は分岐状のアルコキシ基が挙げられる。

直鎖状のアルコキシ基として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*n*-ペンチルオキシ基、*n*-ヘキシルオキシ基、*n*-ヘプチルオキシ基、*n*-オクチルオキシ基、*n*-ノニルオキシ基、*n*-デシルオキシ基、*n*-ウンデシルオキシ基、*n*-ドデシルオキシ基、*n*-トリデシルオキシ基、*n*-テトラデシルオキシ基、*n*-ペンタデシルオキシ基、*n*-ヘキサデシルオキシ基、*n*-ヘプタデシルオキシ基、*n*-オクタデシルオキシ基、*n*-ノナデシルオキシ基、*n*-イコシルオキシ基等が挙げられる。

10

分岐状のアルコキシ基として具体的には、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、*tert*-ペンチルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、*sec*-ヘキシルオキシ基、*tert*-ヘキシルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、*sec*-ヘプチルオキシ基、*tert*-ヘプチルオキシ基、イソオクチルオキシ基、*sec*-オクチルオキシ基、*tert*-オクチルオキシ基、イソノニルオキシ基、*sec*-ノニルオキシ基、*tert*-ノニルオキシ基、イソデシルオキシ基、*sec*-デシルオキシ基、*tert*-デシルオキシ基、イソウンデシルオキシ基、*sec*-ウンデシルオキシ基、*tert*-ウンデシルオキシ基、ネオウンデシルオキシ基、イソドデシルオキシ基、*sec*-ドデシルオキシ基、*tert*-ドデシルオキシ基、ネオドデシルオキシ基、イソトリデシルオキシ基、*sec*-トリデシルオキシ基、*tert*-トリデシルオキシ基、ネオトリデシルオキシ基、イソテトラデシルオキシ基、*sec*-テトラデシルオキシ基、*tert*-テトラデシルオキシ基、ネオテトラデシルオキシ基、1-イソブチル-4-エチルオクチルオキシ基、イソペンタデシルオキシ基、*sec*-ペンタデシルオキシ基、*tert*-ペンタデシルオキシ基、ネオペンタデシルオキシ基、イソヘキサデシルオキシ基、*sec*-ヘキサデシルオキシ基、*tert*-ヘキサデシルオキシ基、ネオヘキサデシルオキシ基、1-メチルペンタデシルオキシ基、イソヘプタデシルオキシ基、*sec*-ヘプタデシルオキシ基、*tert*-ヘプタデシルオキシ基、ネオヘプタデシルオキシ基、イソオクタデシルオキシ基、*sec*-オクタデシルオキシ基、*tert*-オクタデシルオキシ基、ネオオクタデシルオキシ基、イソノナデシルオキシ基、*sec*-ノナデシルオキシ基、*tert*-ノナデシルオキシ基、ネオノナデシルオキシ基、1-メチルオクチルオキシ基、イソイコシルオキシ基、*sec*-イコシルオキシ基、*tert*-イコシルオキシ基、ネオイコシルオキシ基等が挙げられる。

20

30

これらの中でも、アルコキシ基としては、メトキシ基が好ましい。

【0142】

一般式(CT1)において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表すアリール基としては、炭素数6以上30以下(好ましくは6以上20以下、より好ましくは6以上16以下)のアリール基が挙げられる。

アリール基として具体的には、フェニル基、ナフチル基、フェナントリル基、ピフェニル基などが挙げられる。

40

これらの中でも、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基が好ましい。

【0143】

なお、一般式(CT1)において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、上記例示した原子および基(例えばハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基など)が挙げられる。

【0144】

一般式(CT1)において、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} の隣接する二つの置換基同士(例えば R^{C11} 及び R^{C12} 同士、 R^{C13} 及

50

び R^{C14} 同士、 R^{C15} 及び R^{C16} 同士) が連結した炭化水素環構造における、当該置換基同士を連結する基としては、単結合、2, 2' - メチレン基、2, 2' - エチレン基、2, 2' - ビニレン基などが挙げられ、これらの中でも単結合、2, 2' - メチレン基が好ましい。

ここで、炭化水素環構造として具体的には、例えば、シクロアルカン構造、シクロアルケン構造、シクロアルカンポリエン構造等が挙げられる。

【0145】

一般式 (CT1) において、 n 及び m は、1 であることが好ましい。

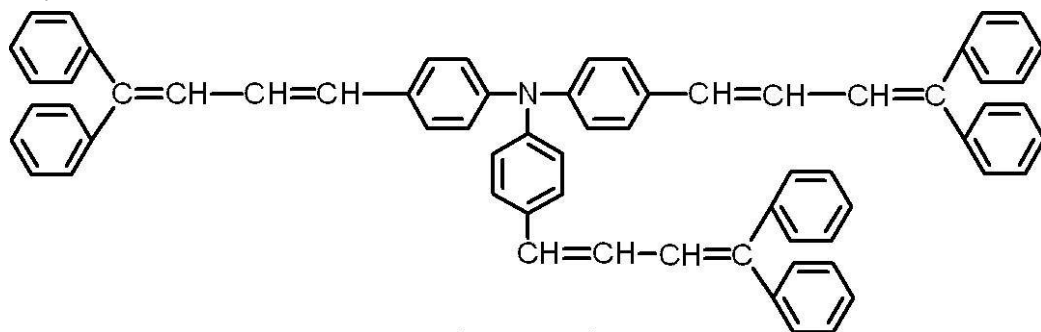
【0146】

一般式 (CT1) において、電荷輸送能の高い感光層 (電荷輸送層) 形成の点から、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子、炭素数 1 以上 20 以下のアルキル基、又は炭素数 1 以上 20 以下のアルコキシ基を表し、 m 及び n が 1 又は 2 を表することが好ましく、 R^{C11} 、 R^{C12} 、 R^{C13} 、 R^{C14} 、 R^{C15} 、及び R^{C16} が水素原子を表し、 m 及び n が 1 を表すことがより好ましい。

つまり、ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) は、下記構造式 (CT1A) で示される電荷輸送材料 (例示化合物 (CT1-3)) であることがより好ましい。

【0147】

【化9】



(CT1A)

【0148】

以下に、ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0149】

【化 1 0】

例示化合物 No.	m	n	R ^{C11}	R ^{C12}	R ^{C13}	R ^{C14}	R ^{C15}	R ^{C16}
CT1- 1	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H
CT1- 2	2	2	H	H	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1- 3	1	1	H	H	H	H	H	H
CT1- 4	2	2	H	H	H	H	H	H
CT1- 5	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H	H
CT1- 6	0	1	H	H	H	H	H	H
CT1- 7	0	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1- 8	0	1	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1- 9	0	1	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H
CT1-10	0	1	H	H	3-CH ₃	3-CH ₃	H	H
CT1-11	0	1	4-CH ₃	H	H	H	4-CH ₃	H
CT1-12	0	1	4-OCH ₃	H	H	H	4-OCH ₃	H
CT1-13	0	1	H	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃	H	H
CT1-14	0	1	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
CT1-15	0	1	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H
CT1-16	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1-17	1	1	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃
CT1-18	1	1	H	H	4-CH ₃	4-CH ₃	H	H
CT1-19	1	1	H	H	3-CH ₃	3-CH ₃	H	H
CT1-20	1	1	4-CH ₃	H	H	H	4-CH ₃	H
CT1-21	1	1	4-OCH ₃	H	H	H	4-OCH ₃	H
CT1-22	1	1	H	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃	H	H
CT1-23	1	1	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	H	4-OCH ₃	4-OCH ₃
CT1-24	1	1	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H	3-CH ₃	H

【 0 1 5 0】

なお、上記例示化合物中の略記号は、以下の意味を示す。また、置換基の前に付す番号は、ベンゼン環に対する置換位置を示している。

- ・ - CH₃ : メチル基
- ・ - OCH₃ : メトキシ基

【 0 1 5 1】

ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【 0 1 5 2】

ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) について説明する。

ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) は、下記一般式 (CT2) で示される電荷輸送材料である。

10

20

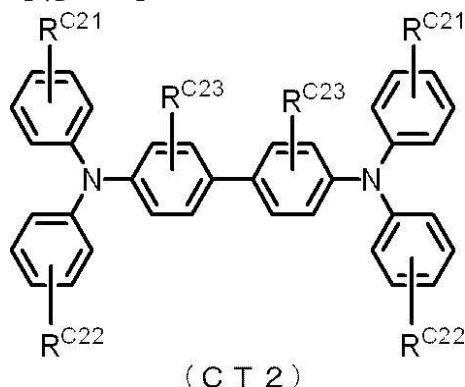
30

40

50

【 0 1 5 3 】

【 化 1 1 】



10

【 0 1 5 4 】

一般式 (CT2) 中、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基、炭素数 1 以上 10 以下のアルコキシ基、又は、炭素数 6 以上 10 以下のアリール基を表す。

【 0 1 5 5 】

一般式 (CT2) において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。これらの中でも、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子が好ましく、塩素原子がより好ましい。

20

【 0 1 5 6 】

一般式 (CT2) において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すアルキル基としては、炭素数 1 以上 10 以下（好ましくは 1 以上 6 以下、より好ましくは 1 以上 4 以下）の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基、イソノニル基、*sec*-ノニル基、*tert*-ノニル基、イソデシル基、*sec*-デシル基、*tert*-デシル基等が挙げられる。

30

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロピル基等の低級アルキル基が好ましい。

【 0 1 5 7 】

一般式 (CT2) において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すアルコキシ基としては、炭素数 1 以上 10 以下（好ましくは 1 以上 6 以下、より好ましくは 1 以上 4 以下）の直鎖状又は分岐状のアルコキシ基が挙げられる。

40

直鎖状のアルコキシ基として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*n*-ペンチルオキシ基、*n*-ヘキシルオキシ基、*n*-ヘプチルオキシ基、*n*-オクチルオキシ基、*n*-ノニルオキシ基、*n*-デシルオキシ基等が挙げられる。

分岐状のアルコキシ基として具体的には、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、*tert*-ペンチルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、*sec*-ヘキシルオキシ基、*tert*-ヘキシルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、*sec*-ヘプチルオキシ基、*tert*-ヘプチルオキシ基、イソオクチルオキシ基、*sec*-オクチルオキシ基、*tert*-オクチルオキシ基、イソノニルオキシ基、*sec*-ノニルオキシ基、*tert*-ノニルオキシ基、イソデシルオキシ基、*sec*-デシルオキシ基、*tert*-デシルオキシ基等が挙げられる。

50

げられる。

これらの中でも、アルコキシ基としては、メトキシ基が好ましい。

【0158】

一般式(CT2)において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表すアリール基としては、炭素数6以上10以下(好ましくは6以上9以下、より好ましくは6以上8以下)のアリール基が挙げられる。

アリール基として具体的には、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。

これらの中でも、アリール基としては、フェニル基が好ましい。

【0159】

なお、一般式(CT2)において、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、上記例示した原子および基(例えばハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基など)が挙げられる。

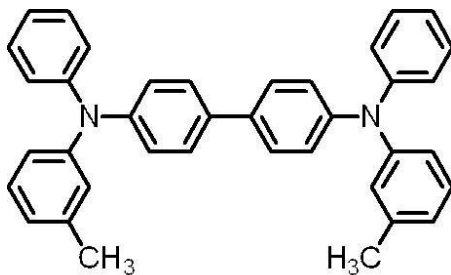
【0160】

一般式(CT2)において、特に、電荷輸送能の高い感光層(電荷輸送層)形成の点から、 R^{C21} 、 R^{C22} 、及び R^{C23} が、各々独立に、水素原子、又は、炭素数1以上10以下のアルキル基を表すことが好ましく、 R^{C21} 、及び R^{C23} が水素原子を表し、 R^{C22} が炭素数1以上10以下のアルキル基(特に、メチル基)を表すことがより好ましい。

具体的には、ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)は、下記構造式(CT2A)で示される電荷輸送材料(例示化合物(CT2-2))であることが特に好ましい。

【0161】

【化12】



(CT2A)

【0162】

以下に、ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0163】

10

20

30

【化 1 3】

例示化合物 No.	R ^{C21}	R ^{C22}	R ^{C23}
CT2- 1	H	H	H
CT2- 2	H	3-CH ₃	H
CT2- 3	H	4-CH ₃	H
CT2- 4	H	3-C ₂ H ₅	H
CT2- 5	H	4-C ₂ H ₅	H
CT2- 6	H	3-OCH ₃	H
CT2- 7	H	4-OCH ₃	H
CT2- 8	H	3-OC ₂ H ₅	H
CT2- 9	H	4-OC ₂ H ₅	H
CT2-10	3-CH ₃	3-CH ₃	H
CT2-11	4-CH ₃	4-CH ₃	H
CT2-12	3-C ₂ H ₅	3-C ₂ H ₅	H
CT2-13	4-C ₂ H ₅	4-C ₂ H ₅	H
CT2-14	H	H	2-CH ₃
CT2-15	H	H	3-CH ₃
CT2-16	H	3-CH ₃	2-CH ₃
CT2-17	H	3-CH ₃	3-CH ₃
CT2-18	H	4-CH ₃	2-CH ₃
CT2-19	H	4-CH ₃	3-CH ₃
CT2-20	3-CH ₃	3-CH ₃	2-CH ₃
CT2-21	3-CH ₃	3-CH ₃	3-CH ₃
CT2-22	4-CH ₃	4-CH ₃	2-CH ₃
CT2-23	4-CH ₃	4-CH ₃	3-CH ₃

10

20

30

【0 1 6 4】

なお、上記例示化合物中の略記号は、以下の意味を示す。また、置換基の前に付す番号は、ベンゼン環に対する置換位置を示している。

- ・ -CH₃ : メチル基
- ・ -C₂H₅ : エチル基
- ・ -OCH₃ : メトキシ基
- ・ -OC₂H₅ : エトキシ基

【0 1 6 5】

ベンジジン系電荷輸送材料(CT2)は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0 1 6 6】

40

50

ヒンダードフェノール系酸化防止剤について説明する。

ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、ヒンダードフェノール環を有し、且つ分子量が 300 以上の化合物である。

【0167】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、ヒンダードフェノール環は、例えば、炭素数 4 以上 8 以下のアルキル基（例えば炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基）が少なくとも一つ置換されたフェノール環である。より具体的には、ヒンダードフェノール環は、例えば、フェノール性水酸基に対してオルトの位置が三級アルキル基（例えば *tert*-ブチル基）で置換されたフェノール環である。

【0168】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、

1) ヒンダードフェノール環を 1 つ有する酸化防止剤、
2) ヒンダードフェノール環を 2 つ以上 4 つ以下有し、且つ直鎖又は分岐状の 2 価以上 4 価以下の脂肪族炭化水素基からなる連結基、又は 2 価以上 4 価以下の脂肪族炭化水素基の炭素 - 炭素の結合間に、エステル結合 (- C (= O) O -) 及びエーテル結合 (- O -) の少なくとも一方が介在した連結基で、2 つ以上 4 つ以下のヒンダードフェノール環が連結された酸化防止剤

3) 2 つ以上 4 つ以下のヒンダードフェノール環と、一つのベンゼン環（未置換、又はアルキル基等で置換された置換ベンゼン環）又はイソシアヌレート環とを有し、2 つ以上 4 つ以下のヒンダードフェノール環が、各々、ベンゼン環又はイソシアヌレート環とアルキレン基を介して連結された酸化防止剤

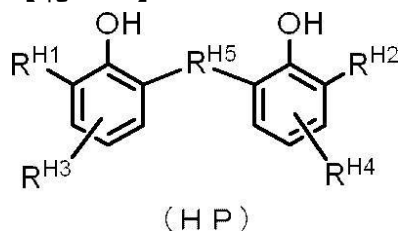
等が挙げられる。

【0169】

具体的には、ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、下記一般式 (HP) で示される酸化防止剤が好ましい。

【0170】

【化14】



【0171】

一般式 (HP) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} は、各々独立に、炭素数 4 以上 8 以下の分岐状のアルキル基を表す。

R^{H3} 、及び R^{H4} は、各々独立に、水素原子、又は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキル基を表す。

R^{H5} は、炭素数 1 以上 10 以下のアルキレン基を表す。

【0172】

一般式 (HP) 中、 R^{H1} 、及び R^{H2} が表すアルキル基としては、炭素数 4 以上 8 以下（好ましくは炭素数 4 以上 6 以下）の分岐状のアルキル基が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基が挙げられる。

これらの中でも、アルキル基としては、*tert*-ブチル基、*tert*-ペンチル基が好ましく、*tert*-ブチル基がより好ましい。

【0173】

一般式(HP)中、 R^{H3} 、及び R^{H4} としては、炭素数1以上10以下(好ましくは炭素数1以上4以下)の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基、イソノニル基、*sec*-ノニル基、*tert*-ノニル基、イソデシル基、*sec*-デシル基、*tert*-デシル基等が挙げられる。

10

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0174】

一般式(HP)中、 R^{H5} は、炭素数1以上10以下(好ましくは1以上4以下)の直鎖状又は分岐状アルキレン基を表す。

直鎖状のアルキレン基として具体的には、メチレン基、エチレン基、*n*-プロピレン基、*n*-ブチレン基、*n*-ペンチレン基、*n*-ヘキシレン基、*n*-ヘプチレン基、*n*-オクチレン基、*n*-ノニレン基、*n*-デシレン基等が挙げられる。

分岐状のアルキレン基として具体的には、イソプロピレン基、イソブチレン基、*sec*-ブチレン基、*tert*-ブチレン基、イソペンチレン基、ネオペンチレン基、*tert*-ペンチレン基、イソヘキシレン基、*sec*-ヘキシレン基、*tert*-ヘキシレン基、イソヘプチレン基、*sec*-ヘプチレン基、*tert*-ヘプチレン基、イソオクチレン基、*sec*-オクチレン基、*tert*-オクチレン基、イソノニレン基、*sec*-ノニレン基、*tert*-ノニレン基、イソデシレン基、*sec*-デシレン基、*tert*-デシレン基等が挙げられる。

20

これらの中でも、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、ブチレン基等の低級アルキレン基が好ましい。

【0175】

なお、一般式(HP)中、 R^{H1} 、 R^{H2} 、 R^{H3} 、 R^{H4} 、及び R^{H5} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、例えば、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子)、アルコキシ基(例えば炭素数1以上4以下のアルコキシ基)、アリアル基(例えばフェニル基、ナフチル基等)等が挙げられる。

30

【0176】

一般式(HP)において、特に、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、 R^{H1} 、及び R^{H2} が*tert*-ブチル基を表すことが好ましく、 R^{H1} 、及び R^{H2} が*tert*-ブチル基を表し、 R^{H3} 、及び R^{H4} が炭素数1以上3以下のアルキル基(特にメチル基)を示し、 R^{H5} が炭素数1以上4以下のアルキレン基(特にメチレン基)を表すことが好ましい。

具体的には、ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、例示化合物(HP-3)で示されるヒンダードフェノール系酸化防止剤が特に好ましい。

40

【0177】

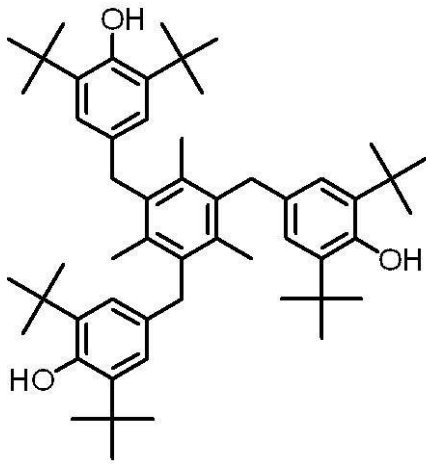
ヒンダードフェノール系酸化防止剤の分子量は、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、300以上1000以下が好ましく、300以上900以下がより好ましく、300以上800以下が更に好ましい。

【0178】

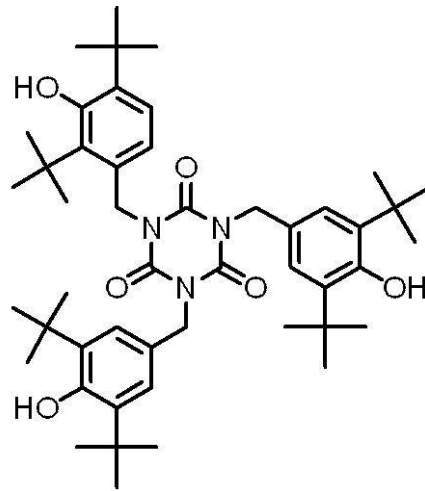
以下に、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0179】

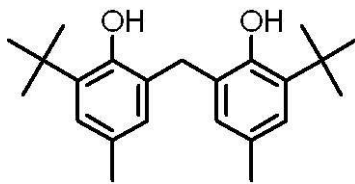
【化 1 5】



(HP-1)



(HP-2)



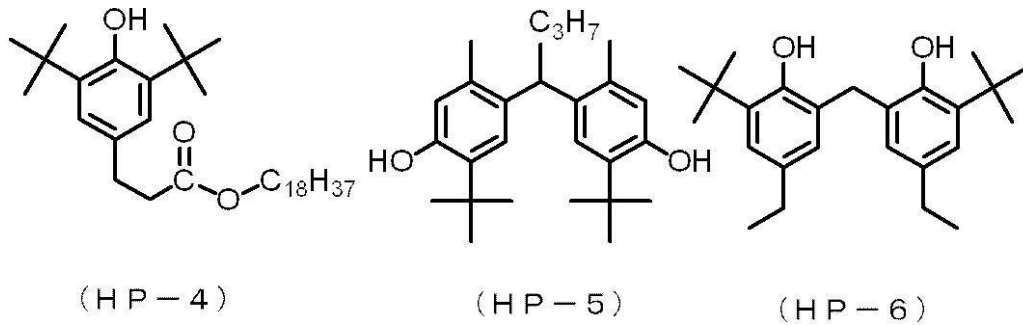
(HP-3)

【 0 1 8 0 】

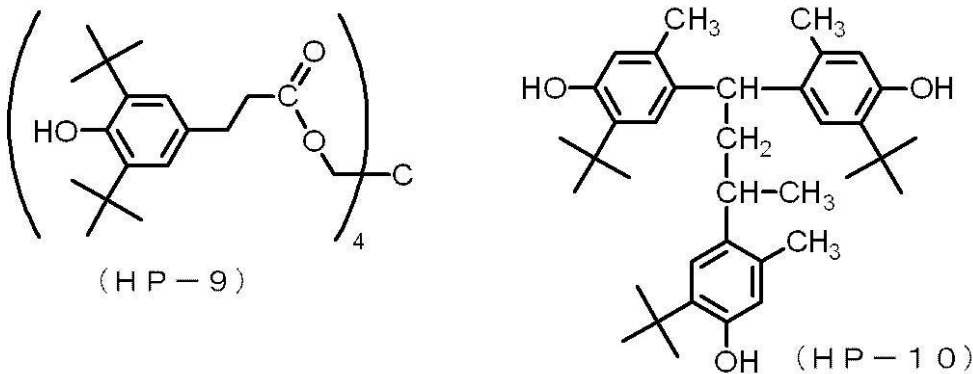
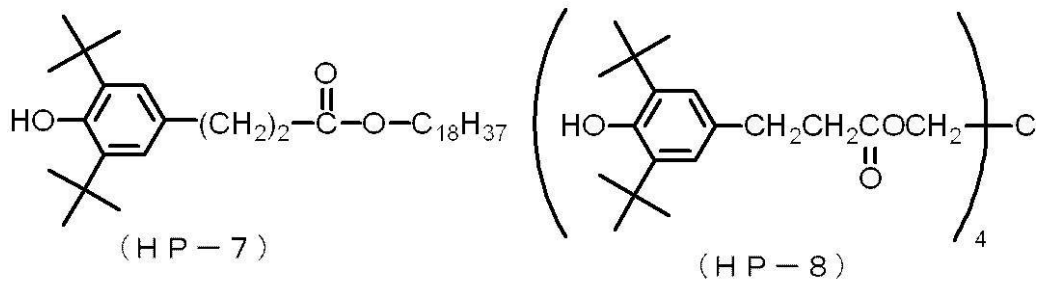
10

20

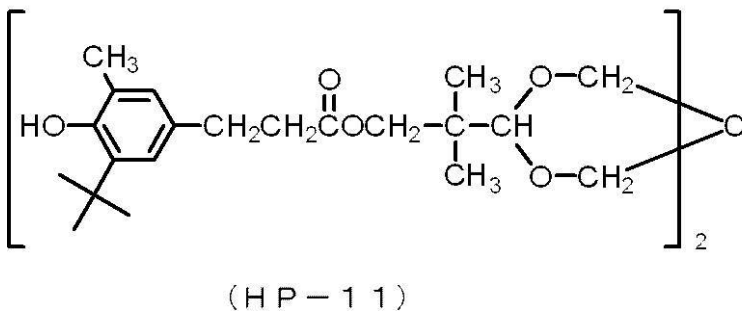
【化 16】



10



20



30

【0181】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

【0182】

次に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤について説明する。

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、ベンゾフェノン骨格を有する化合物である。

【0183】

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、1) 2つのベンゼン環が無置換の化合物、2) 2つのベンゼン環に、各々に独立に、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、及びアリール基よりなる群から選択される少なくとも一つの置換基で置換された化合物が挙げられる。特に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、2つのベンゼン環の一方に、

50

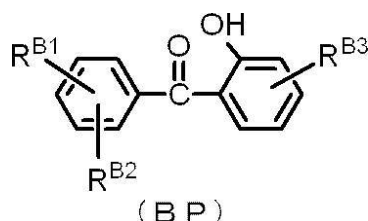
少なくとも水酸基が置換（特に、 $-C(=O)-$ 基に対してオルトの位置に置換）されている化合物がよい。

【0184】

具体的には、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、下記一般式（BP）で示される紫外線吸収剤が好ましい。

【0185】

【化17】



10

【0186】

一般式（BP）中、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上10以下のアルキル基、炭素数1以上10以下のアルコキシ基、又は、炭素数6以上10以下のアリール基を表す。ただし、 R^{B3} は水酸基を表してもよい。

【0187】

一般式（BP）において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。これらの中でも、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子が好ましく、塩素原子がより好ましい。

20

【0188】

一般式（BP）において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すアルキル基としては、炭素数1以上10以下（好ましくは1以上6以下、より好ましくは1以上4以下）の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基、イソヘプチル基、*sec*-ヘプチル基、*tert*-ヘプチル基、イソオクチル基、*sec*-オクチル基、*tert*-オクチル基、イソノニル基、*sec*-ノニル基、*tert*-ノニル基、イソデシル基、*sec*-デシル基、*tert*-デシル基等が挙げられる。

30

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基、イソプロピル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0189】

一般式（BP）において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すアルコキシ基としては、炭素数1以上10以下（好ましくは1以上6以下、より好ましくは1以上4以下）の直鎖状又は分岐状のアルコキシ基が挙げられる。

40

直鎖状のアルコキシ基として具体的には、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*n*-ペンチルオキシ基、*n*-ヘキシルオキシ基、*n*-ヘプチルオキシ基、*n*-オクチルオキシ基、*n*-ノニルオキシ基、*n*-デシルオキシ基等が挙げられる。

分岐状のアルコキシ基として具体的には、イソプロポキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、*tert*-ペンチルオキシ基、イソヘキシルオキシ基、*sec*-ヘキシルオキシ基、*tert*-ヘキシルオキシ基、イソヘプチルオキシ基、*sec*-ヘプチルオキシ基、*tert*-ヘプチルオキシ基、イソオクチルオキシ基、*sec*-オクチルオキシ基、*tert*-オクチルオキシ基、イソノニルオキシ基、*sec*-ノニルオキシ基、*tert*-ノニルオキシ基、イソデシルオキシ基、*sec*-デシルオキシ基、*tert*-デシルオキシ基等が挙

50

げられる。

これらの中でも、アルコキシ基としては、メトキシ基が好ましい。

【0190】

一般式 (B P) において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表すアリール基としては、炭素数 6 以上 10 以下 (好ましくは 6 以上 9 以下、より好ましくは 6 以上 8 以下) のアリール基が挙げられる。

アリール基として具体的には、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。

これらの中でも、アリール基としては、フェニル基が好ましい。

【0191】

なお、一般式 (B P) において、 R^{B1} 、 R^{B2} 、及び R^{B3} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、上記例示した原子および基 (例えばハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基など) が挙げられる。

10

【0192】

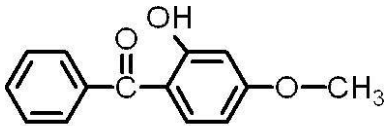
一般式 (B P) において、特に、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、 R^{B1} 、及び R^{B2} が水素原子を表し、 R^{B3} が炭素数 1 以上 3 以下のアルコキシ基を表すことが好ましい。

具体的には、紫外線吸収剤は、下記構造式 (B P A) で示される電荷輸送材料 (例示化合物 (B P - 3)) であることが特に好ましい。

【0193】

【化18】

20



(B P A)

【0194】

以下に、一般式 (B P) で示される紫外線吸収剤の具体例を示すが、これに限定されるわけではない。

【0195】

30

【化 1 9】

例示化合物 No.	R ^{B1}	R ^{B2}	R ^{B3}
BP- 1	H	H	4-OH
BP- 2	H	H	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 3	H	H	4-OCH ₃
BP- 4	H	H	H
BP- 5	H	3-CH ₃	4-OH
BP- 6	H	3-CH ₃	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP- 7	H	3-CH ₃	4-OCH ₃
BP- 8	H	3-CH ₃	H
BP- 9	H	4-CH ₃	4-OH
BP-10	H	4-CH ₃	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP-11	H	4-CH ₃	4-OCH ₃
BP-12	H	4-CH ₃	H
BP-13	2-CH ₃	4-CH ₃	4-OH
BP-14	2-CH ₃	4-CH ₃	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP-15	2-CH ₃	4-CH ₃	4-OCH ₃
BP-16	2-CH ₃	4-CH ₃	H
BP-17	H	3-C ₂ H ₅	4-OH
BP-18	H	3-C ₂ H ₅	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP-19	H	3-C ₂ H ₅	4-OCH ₃
BP-20	H	3-C ₂ H ₅	H
BP-21	H	4-C ₂ H ₅	4-OH
BP-22	H	4-C ₂ H ₅	4-(CH ₂) ₇ -CH ₃
BP-23	H	4-C ₂ H ₅	4-OCH ₃
BP-24	H	4-C ₂ H ₅	H

【0 1 9 6】

なお、上記例示化合物中の略記号は、以下の意味を示す。また、置換基の前に付す番号は、ベンゼン環に対する置換位置を示している。

- ・ - CH₃ : メチル基
- ・ - C₂H₅ : エチル基
- ・ - (CH₂)₇-CH₃ : オクチル基
- ・ - OCH₃ : メトキシ基
- ・ - OH : ヒドロキシ基

【0 1 9 7】

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用して

10

20

30

40

50

もよい。

【0198】

次に、電荷輸送材料、酸化防止剤および紫外線吸収剤の含有量について説明する。

ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の含有量は、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、CT1と結着樹脂との配合比（質量比 CT1：結着樹脂）で0.1：9.9から4.0：6.0までの範囲内であることが好ましく、0.4：9.6から3.5：6.5までの範囲内であることがより好ましく、0.6：9.4から3.0：7.0の範囲内であることが更に好ましい。

【0199】

ベンジジン系電荷輸送材料（CT2）の含有量は、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、CT2と結着樹脂との配合比（質量比 CT2：結着樹脂）で、：9から7：3までの範囲内であることが好ましく、2：8から6：4までの範囲内であることがより好ましく、2：8から4：6の範囲内であることが更に好ましい。

10

【0200】

ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の含有量とベンジジン系電荷輸送材料（CT2）の含有量との質量比（ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の含有量／ベンジジン系電荷輸送材料（CT2）の含有量）は、電荷輸送能の高い感光層（電荷輸送層）形成の点から、1／9以上5／5以下が好ましく、1／9以上4／6以下がより好ましく、1／9以上3／7以下が更に好ましい。

特に、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）の含有量とベンジジン系電荷輸送材料（CT2）の含有量との質量比が上記範囲であると、焼付きゴースト及び光疲労が生じ易い、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤よりなる群から選択される少なくとも1種により、焼付きゴースト及び光疲労の発生が抑制される。

20

【0201】

なお、ブタジエン系電荷輸送材料（CT1）およびベンジジン系電荷輸送材料（CT2）以外の他の電荷輸送材料を併用してもよい。但し、その場合、全電荷輸送材料に占める他の電荷輸送材料の含有量は、10質量％以下（好ましくは5質量％以下）であることがよい。

【0202】

ヒンダードフェノール系酸化防止剤の含有量は、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、全電荷輸送材料量100質量％に対して、0.5質量％以上30.0質量％以下が好ましく、0.5質量％以上15質量％以下がより好ましく、0.5質量％以上9.0質量％以下が更に好ましい。なお、このヒンダードフェノール系酸化防止剤の含有量は、全電荷輸送材料の含有量を100質量部としたときの部数（質量部）を示している。

30

【0203】

ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の含有量は、焼付きゴースト及び光疲労の抑制の点から、全電荷輸送材料量100質量％に対して、0.5質量％以上30.0質量％以下が好ましく、0.5質量％以上15質量％以下がより好ましく、0.5質量％以上9.0質量％以下が更に好ましい。なお、このベンゾフェノン系紫外線吸収剤の含有量は、全電荷輸送材料の含有量を100質量部としたときの部数（質量部）を示している。

40

【0204】

なお、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤の含有量は、共に、30.0質量％以下とすることで、酸化防止剤および紫外線吸収剤による電荷輸送材料の電荷輸送能力の障害が抑制される。つまり、光照射による感光体表面への静電潜像形成の障害が抑制され、目的とする濃度の画像が得られ易くなる。

【0205】

次に結着樹脂について説明する。

電荷輸送層に用いる結着樹脂は、BPポリカーボネート樹脂が適用される。BPポリカーボネート樹脂は、ビフェニル骨格を有する構造単位を含むビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂である。

50

【 0 2 0 6 】

B P ポリカーボネート樹脂としては、例えば、ビフェニル骨格を有する構造単位として、下記一般式 (P C A) で示される構造単位と、他の構造単位とを有するビフェニル共重合型ポリカーボネート樹脂が挙げられる。

他の構造単位としては、ビスフェノール骨格 (例えば、ビスフェノール A、ビスフェノール B、ビスフェノール B P、ビスフェノール C、ビスフェノール F、ビスフェノール Z 等) を有する構造単位等が挙げられる。

【 0 2 0 7 】

B P ポリカーボネート樹脂として具体的には、例えば、ジヒドロキシビフェニル化合物と、ジヒドロキシビスフェノール化合物との共重合体が挙げられる。なお、この共重合体は、例えば、ジヒドロキシビフェニル化合物およびジヒドロキシビスフェノール化合物を原料として用い、ホスゲン等の炭酸エステル形成性化合物との重縮合又はビスアリールカーボネートとのエステル交換反応等の方法によって得られる。

【 0 2 0 8 】

ジヒドロキシビフェニル化合物は、ビフェニル骨格を有し、ビフェニル骨格の 2 つのベンゼン環に、各々、一つのヒドロキシル基を有するビフェニル化合物である。ジヒドロキシビフェニル化合物としては、例えば、4, 4' - ジヒドロキシビフェニル、4, 4' - ジヒドロキシ - 3, 3' - ジメチルビフェニル、4, 4' - ジヒドロキシ - 2, 2' - ジメチルビフェニル、4, 4' - ジヒドロキシ - 3, 3' - ジシクロヘキシルビフェニル、3, 3' - ジフルオロ - 4, 4' - ジヒドロキシビフェニル、4, 4' - ジヒドロキシ - 3, 3' - ジフェニルビフェニル等が挙げられる。

これらジヒドロキシビフェニル化合物は、1 種単独で用いてもよいし、複数併用してもよい。

【 0 2 0 9 】

ジヒドロキシビスフェノール化合物は、ビスフェノール骨格を有し、ビスフェノール骨格の 2 つのベンゼン環に、各々、一つのヒドロキシル基を有するビスフェノール化合物である。ジヒドロキシビスフェノール化合物としては、例えば、ビス (4 - ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) エタン、1, 2 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) エタン、2, 2 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2 - ビス (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) ブタン、2, 2 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) ブタン、2, 2 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) オクタン、4, 4 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) ヘプタン、1, 1 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) - 1, 1 - ジフェニルメタン、1, 1 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) - 1 - フェニルエタン、1, 1 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) - 1 - フェニルメタン、ビス (4 - ヒドロキシフェニル) エーテル、ビス (4 - ヒドロキシフェニル) スルフィド、ビス (4 - ヒドロキシフェニル) スルホン、1, 1 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) シクロペンタン、1, 1 - ビス (4 - ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、2, 2 - ビス (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) プロパン、2 - (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) - 2 - (4 - ヒドロキシフェニル) - 1 - フェニルエタン、ビス (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) スルフィド、ビス (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) スルホン、ビス (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1 - ビス (3 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、2, 2 - ビス (2 - メチル - 4 - ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 1 - ビス (2 - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルフェニル) ブタン、1, 1 - ビス (2 - tert - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 3 - メチルフェニル) エタン、1, 1 - ビス (2 - tert - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルフェニル) プロパン、1, 1 - ビス (2 - tert - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルフェニル) ブタン、1, 1 - ビス (2 - tert - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルフェニル) イソブタン、1, 1 - ビス (2 - tert - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルフェニル) ヘプタン、1, 1 - ビス (2 - tert - ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルフェニル) - 1 - フェニルメタン、1, 1 - ビス (2 - tert - アミル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチ

10

20

30

40

50

ルフェニル)ブタン、ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェニル)メタン、2,2-ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-ブromo-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-ブromo-4-ヒドロキシ-5-クロロフェニル)プロパン、2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2-ビス(3,5-ジブromo-4-ヒドロキシフェニル)ブタン、1-フェニル-1,1-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)エタン、ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)エーテル、1,1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン等が挙げられる。

10

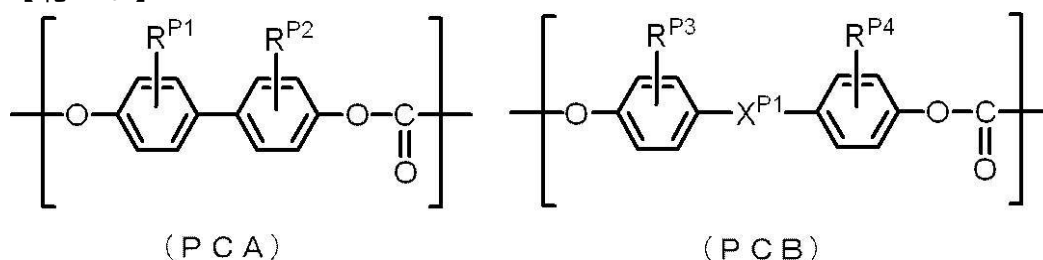
これらビスフェノール化合物は、1種単独で用いてもよいし、複数併用してもよい。

【0210】

これらの中でも、BPポリカーボネート樹脂は、感光層(電荷輸送層)の耐摩耗性の点から、下記一般式(PCA)で示される構造単位と、下記一般式(PCB)で示される構造単位と、を含むポリカーボネート樹脂であることが好ましい。

【0211】

【化20】



20

【0212】

一般式(PCA)及び(PCB)中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上6以下のアルキル基、炭素数5以上7以下のシクロアルキル基、又は、炭素数6以上12以下のアリール基を表す。 X^{P1} は、フェニレン基、ビフェニレン基、ナフチレン基、アルキレン基、又は、シクロアルキレン基を表す。

30

【0213】

一般式(PCA)及び(PCB)中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} が表すアルキル基としては、炭素数1以上6以下(好ましくは炭素数1以上3以下)の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。

直鎖状のアルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基等が挙げられる。

分岐状のアルキル基として具体的には、イソプロピル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、イソヘキシル基、*sec*-ヘキシル基、*tert*-ヘキシル基等が挙げられる。

40

これらの中でも、アルキル基としては、メチル基、エチル基等の低級アルキル基が好ましい。

【0214】

一般式(PCA)及び(PCB)中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} が表すシクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルが挙げられる。

【0215】

一般式(PCA)及び(PCB)中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、及び R^{P4} が表すアリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基等が挙げられる。

50

【0216】

一般式(PCA)及び(PCB)中、 X^{P1} が表すアルキレン基としては、炭素数1以上12以下(好ましくは炭素数1以上6以下、より好ましくは炭素数1以上3以下)の直鎖状又は分岐状のアルキレン基が挙げられる。

直鎖状のアルキレン基として具体的には、メチレン基、エチレン基、*n*-プロピレン基、*n*-ブチレン基、*n*-ペンチレン基、*n*-ヘキシレン基、*n*-ヘプチレン基、*n*-オクチレン基、*n*-ノニレン基、*n*-デシレン基、*n*-ウンデシレン基、*n*-ドデシレン基等が挙げられる。

分岐状のアルキレン基として具体的には、イソプロピレン基、イソブチレン基、*sec*-ブチレン基、*tert*-ブチレン基、イソペンチレン基、ネオペンチレン基、*tert*-ペンチレン基、イソヘキシレン基、*sec*-ヘキシレン基、*tert*-ヘキシレン基、イソヘプチレン基、*sec*-ヘプチレン基、*tert*-ヘプチレン基、イソオクチレン基、*sec*-オクチレン基、*tert*-オクチレン基、イソノニレン基、*sec*-ノニレン基、*tert*-ノニレン基、イソデシレン基、*sec*-デシレン基、*tert*-デシレン基、イソウンデシレン基、*sec*-ウンデシレン基、*tert*-ウンデシレン基、ネオウンデシレン基、イソドデシレン基、*sec*-ドデシレン基、*tert*-ドデシレン基、ネオドデシレン基等が挙げられる。

これらの中でも、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、ブチレン基等の低級アルキル基が好ましい。

【0217】

一般式(PCA)及び(PCB)中、 X^{P1} が表すシクロアルキレン基としては、炭素数3以上12以下(好ましくは炭素数3以上10以下、より好ましくは炭素数5以上8以下)のシクロアルキレン基が挙げられる。

シクロアルキル基として具体的には、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロドデカニル基等が挙げられる。

これらの中でも、シクロアルキル基としては、シクロヘキシル基が好ましい。

【0218】

なお、一般式(PCA)及び(PCB)中、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、及び X^{P1} が表す上記各置換基は、さらに置換基を有する基も含む。この置換基としては、例えば、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子)、アルキル基(例えば炭素数1以上6以下のアルキル基)、シクロアルキル基(例えば炭素数5以上7以下のシクロアルキル基)、アルコキシ基(例えば炭素数1以上4以下のアルコキシ基)、アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基、ピフェニル基等)等が挙げられる。

【0219】

一般式(PCA)において、 R^{P1} 、及び R^{P2} は、各々独立に、水素原子、又は炭素数1以上6以下のアルキル基を表すことが好ましく、 R^{P1} 、及び R^{P2} は、水素原子を表すことがより好ましい。

一般式(PCB)において、 R^{P3} 、及び R^{P4} は、各々独立に、水素原子、又は炭素数1以上6以下のアルキル基を表し、 X^{P1} がアルキレン基、又はシクロアルキレン基を表すことが好ましい。

【0220】

B Pポリカーボネート樹脂の具体例としては、例えば、以下のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、例示化合物中、*p*m、*p*nは共重合比を示す。

【0221】

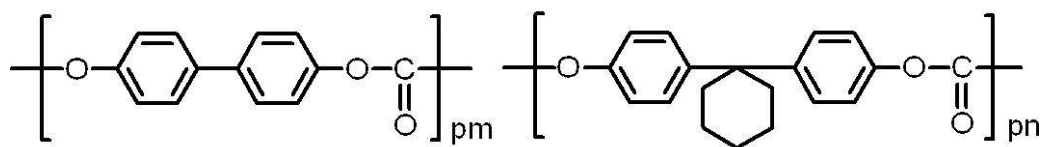
10

20

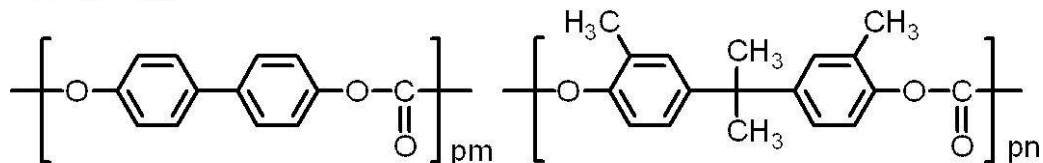
30

40

【化 2 1】
(P C-1)

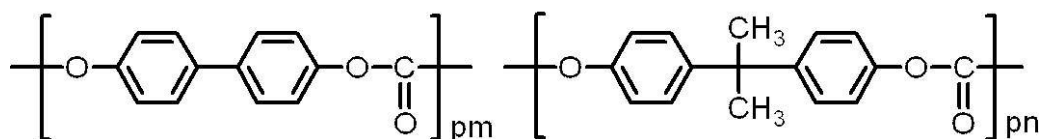


(P C-2)



10

(P C-3)



20

【 0 2 2 2】

ここで、B P ポリカーボネート樹脂において、一般式 (P C A) で示される構造単位の含有率 (共重合比) は、B P ポリカーボネート樹脂を構成する全構造単位に対して 5 モル % 以上 9 5 モル % 以下の範囲がよく、感光層 (電荷輸送層) の耐磨耗性を高める観点から、好ましくは 5 モル % 以上 5 0 モル % 以下の範囲、さらに好ましくは 1 5 モル % 以上 3 0 モル % 以下の範囲である。

具体的には、B P ポリカーボネート樹脂の上記例示化合物中、p m、p n は共重合比 (モル比) を示すが、p m : p n = 9 5 : 5 から 5 : 9 5 の範囲、5 0 : 5 0 から 5 : 9 5 の範囲、更に好ましくは、1 5 : 8 5 から 3 0 : 7 0 の範囲が挙げられる。

【 0 2 2 3】

30

B P ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量としては、例えば 2 0 , 0 0 0 以上 8 0 , 0 0 0 以下が好ましい。

なお、B P ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量の測定方法としては、次の方法により測定される値である。樹脂 1 g をメチレンクロライド 1 0 0 c m³ に均一溶解し、2 5 の測定環境下でウペローデ粘度計により、その比粘度 s p を測定し、s p / c = [] + 0 . 4 5 []² c の関係式 (ただし c は濃度 (g / c m³) より極限粘度 [] (c m³ / g) をもとめ、H . S c h n e l l によって与えられている式、[] = 1 . 2 3 × 1 0⁻⁴ M v 0 . 8 3 の関係式より粘度平均分子量 M v を求める。

【 0 2 2 4】

B P ポリカーボネート樹脂は、他の結着樹脂と併用してもよい。ただし、他の結着樹脂は、全結着樹脂に対して 1 0 質量 % (好ましくは 5 質量 % 以下) で併用することがよい。

40

【 0 2 2 5】

ここで、B P ポリカーボネート樹脂の含有量は、例えば、感光層 (電荷輸送層) の全固形分に対して、1 0 質量 % 以上 9 0 質量 % 以下が好ましく、3 0 質量 % 以上 9 0 質量 % 以下がより好ましく、5 0 質量 % 以上 9 0 質量 % 以下が更に好ましい。

なお、全結着樹脂と電荷輸送材料との配合比 (質量比 = 結着樹脂 : 電荷輸送材料) は 1 0 : 1 から 1 : 5 までが望ましい。

【 0 2 2 6】

次に、フッ素含有樹脂粒子について説明する。

フッ素含有樹脂粒子としては、例えば、4 フッ化エチレン樹脂、3 フッ化塩化エチレン

50

樹脂、6フッ化プロピレン樹脂、フッ化ビニル樹脂、フッ化ビニリデン樹脂、2フッ化2塩化エチレン樹脂及びそれらの共重合体の粒子の中から1種又は2種以上を選択するのが望ましい。これらの中でも、フッ素含有樹脂粒子としては、特に、4フッ化エチレン樹脂粒子、フッ化ビニリデン樹脂粒子が望ましい。

【0227】

フッ素含有樹脂粒子の一次粒径は、 $0.05\mu\text{m}$ 以上 $1\mu\text{m}$ 以下であることがよく、望ましくは $0.1\mu\text{m}$ 以上 $0.5\mu\text{m}$ 以下である。

なお、この一次粒子は、感光層（電荷輸送層）から試料片を得て、これをSEM（走査型電子顕微鏡）により例えば倍率5000倍以上で観察し、一次粒子状態のフッ素樹脂粒子の最大径を測定し、これを50個の粒子について行った平均値とする。なお、SEMとして日本電子製JSM-6700Fを使用し、加速電圧5kVの二次電子画像を観察する。

10

【0228】

フッ素樹脂粒子の市販品としては、例えば、ルブロン（登録商標）シリーズ（ダイキン工業株式会社製）、テフロン（登録商標）シリーズ（デュポン製）、ダイニオン（登録商標）シリーズ（住友3M製）等が挙げられる。

【0229】

フッ素含有樹脂粒子の含有量は、感光層（電荷輸送層）の全固形分に対して、1質量%以上30質量%以下が好ましく、3質量%以上20質量%以下がより好ましく、5質量%以上15質量%以下が更に好ましい。

20

【0230】

次に、フッ素含有分散剤について説明する。

フッ素含有分散剤としては、フッ化アルキル基を有する重合性化合物を単独重合又は共重合した重合体（以下「フッ化アルキル基含有重合体」とも称する）が挙げられる。

【0231】

フッ素含有分散剤として具体的には、フッ化アルキル基を有する（メタ）アクリレートの単独重合体、フッ化アルキル基を有する（メタ）アクリレートとフッ素原子を有さないモノマーとのランダム又はブロック共重合体等が挙げられる。なお、（メタ）アクリレートとは、アクリレートおよびメタクリレートの双方を意味する。

フッ化アルキル基を有する（メタ）アクリレートとしては、例えば、2,2,2-トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレートが挙げられる。

30

フッ素原子を有さないモノマーとしては、例えば、（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、t-ブチル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、2-メトキシエチル（メタ）アクリレート、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、2-エトキシエチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、エチルカルビトール（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、4-ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、フェノキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル o-フェニルフェノール（メタ）アクリレート、o-フェニルフェノールグリシジルエーテル（メタ）アクリレートが挙げられる。

40

【0232】

その他、フッ素含有分散剤として具体的には、米国特許5637142号明細書、特許第4251662号公報などに開示されたブロック又はブランチポリマーも挙げられる。更に、フッ素含有分散剤として具体的には、フッ素系界面活性剤も挙げられる。

50

【 0 2 3 3 】

これらの中でも、フッ素含有分散剤としては、下記一般式（F A）で示される構造単位を有するフッ化アルキル基含有重合体が好ましく、下記一般式（F B）で示される構造単位と、下記一般式（F B）で示される構造単位とを有するフッ化アルキル基含有重合体により好ましい。

【 0 2 3 4 】

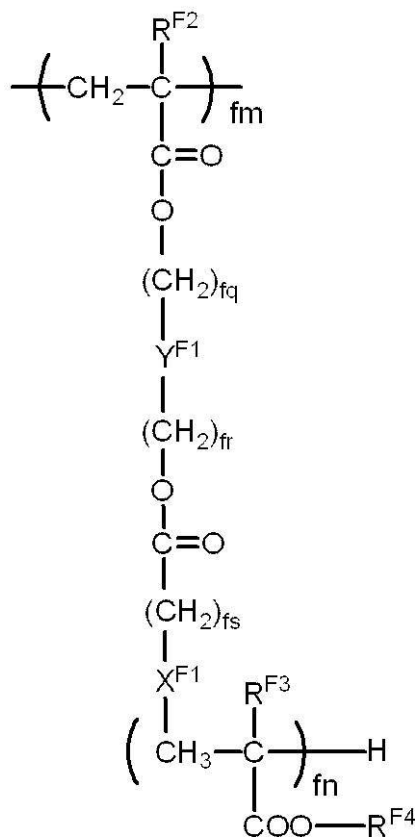
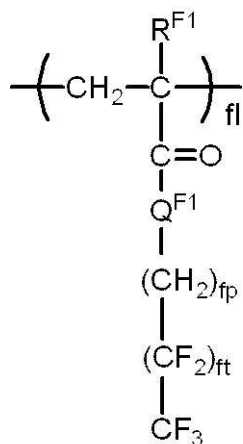
以下、下記一般式（F A）で示される構造単位と、下記一般式（F B）で示される構造単位とを有するフッ化アルキル基含有重合体について説明する。

【 0 2 3 5 】

【 化 2 2 】

（F A）

（F B）



【 0 2 3 6 】

一般式（F A）及び（F B）中、 $\text{R}^{\text{F}1}$ 、 $\text{R}^{\text{F}2}$ 、 $\text{R}^{\text{F}3}$ 及び $\text{R}^{\text{F}4}$ は、各々独立に、水素原子、又はアルキル基を表す。

$\text{X}^{\text{F}1}$ は、アルキレン鎖、ハロゲン置換アルキレン鎖、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、又は単結合を表す。

$\text{Y}^{\text{F}1}$ は、アルキレン鎖、ハロゲン置換アルキレン鎖、 $-(\text{C}_{\text{fx}}\text{H}_{2\text{fx}-1}(\text{OH}))$ - 又は単結合を表す。

$\text{Q}^{\text{F}1}$ は、 $-\text{O}-$ 、又は $-\text{NH}-$ を表す。

fl 、 fm 及び fn は、各々独立に、1以上の整数を表す。

fp 、 fq 、 fr 及び fs は、各々独立に、0または1以上の整数を表す。

ft は、1以上7以下の整数を表す。

fx は1以上の整数を表す。

【 0 2 3 7 】

一般式（F A）及び（F B）中、 $\text{R}^{\text{F}1}$ 、 $\text{R}^{\text{F}2}$ 、 $\text{R}^{\text{F}3}$ 及び $\text{R}^{\text{F}4}$ を表す基としては、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基等が好ましく、水素原子、メチル基がより

好ましく、メチル基が更に好ましい。

【0238】

一般式(F A)及び(F B)中、 X^{F1} 及び Y^{F1} を表すアルキレン鎖(未置換アルキレン鎖、ハロゲン置換アルキレン鎖)としては、炭素数1以上10以下の直鎖状又は分岐状のアルキレン鎖が好ましい。

Y^{F1} を表す $-(C_{fx}H_{2fx-1}(OH))-$ 中の fx は、1以上10以下の整数を表すことが好ましい。

f_p 、 f_q 、 f_r 及び f_s は、それぞれ独立に0または1以上10以下の整数を表すことが好ましい。

f_n は、例えば、1以上60以下が好ましい。

10

【0239】

ここで、フッ素含有分散剤において、一般式(F A)で示される構造単位と一般式(F B)で示される構造単位との比、つまり、 $f_l : f_m$ は、1 : 9から9 : 1までの範囲が好ましく、3 : 7から7 : 3までの範囲がより好ましい。

【0240】

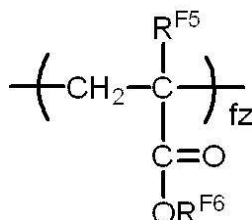
また、フッ素含有分散剤、一般式(F A)で示される構造単位と一般式(F B)で示される構造単位に加え、一般式(F C)で示される構造単位を更に有していてもよい。一般式(F C)で示される構造単位の含有比は、一般式(F A)及び(F B)で示される構造単位の合計、即ち $f_l + f_m$ との比($f_l + f_m : f_z$)で、10 : 0から7 : 3までの範囲が好ましく、9 : 1から7 : 3までの範囲がより好ましい。

20

【0241】

【化23】

(F C)



30

【0242】

一般式(F C)中、 R^{F5} 、及び R^{F6} は、各々独立に、水素原子、又はアルキル基を表す。 f_z は、1以上の整数を表す。

【0243】

一般式(F C)中、 R^{F5} 、及び R^{F6} を表す基としては、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基等が好ましく、水素原子、メチル基がより好ましく、メチル基が更に好ましい。

【0244】

40

フッ素含有分散剤の市販品としては、例えば、GF300、GF400(東亜合成社製)、サーフロンシリーズ(AGCセイミケカル社製)、フタージェントシリーズ(ネオス社製)、PFシリーズ(北村化学社製)、メガファックシリーズ(DIC製)、FCシリーズ(3M製)等が挙げられる。

【0245】

フッ素含有分散剤の重量平均分子量は、例えば、2000以上250000以下が好ましく、3000以上150000以下がより好ましく、50000以上100000以下が更に好ましい。

フッ素含有分散剤の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)により測定される値である。GPCによる分子量測定は、例えば、測定装置として東

50

ソー製GPC・HLC-8120を用い、東ソー製カラム・TSK gel GMHHR-M+TSK gel GMHHR-M(7.8mm I.D. 30cm)を使用し、クロロホルム溶媒で行い、この測定結果から単分散ポリスチレン標準試料により作製した分子量校正曲線を使用して算出する。

【0246】

フッ化アルキル基含有共重合体の含有量は、例えば、フッ素含有樹脂粒子の質量に対して0.5質量%以上10質量%以下が好ましく、1質量%以上7質量%以下がより好ましい。

なお、フッ化アルキル基含有共重合体は、1種を単独でまたは2種以上を併用してもよい。

10

【0247】

電荷輸送層には、その他、周知の添加剤が含まれていてもよい。

【0248】

電荷輸送層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた電荷輸送層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥、必要に応じて加熱することで行う。

【0249】

電荷輸送層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン等の芳香族炭化水素類；アセトン、2-ブタノン等のケトン類；塩化メチレン、クロロホルム、塩化エチレン等のハロゲン化脂肪族炭化水素類；テトラヒドロフラン、エチルエーテル等の環状又は直鎖状のエーテル類等の通常の有機溶剤が挙げられる。これら溶剤は、単独で又は2種以上混合して用いる。

20

【0250】

電荷輸送層形成用塗布液を電荷発生層の上に塗布する際の塗布方法としては、ブレード塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、浸漬塗布法、ビード塗布法、エアナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

【0251】

電荷輸送層の膜厚は、例えば、好ましくは5 μm以上50 μm以下、より好ましくは10 μm以上30 μm以下の範囲内に設定される。

【0252】

30

(保護層)

保護層は、必要に応じて感光層上に設けられる。保護層は、例えば、帯電時の感光層の化学的变化を防止したり、感光層の機械的強度をさらに改善する目的で設けられる。

そのため、保護層は、硬化膜(架橋膜)で構成された層を適用することがよい。これら層としては、例えば、下記1)又は2)に示す層が挙げられる。

【0253】

1) 反応性基及び電荷輸送性骨格を同一分子内に有する反応性基含有電荷輸送材料を含む組成物の硬化膜で構成された層(つまり当該反応性基含有電荷輸送材料の重合体又は架橋体を含む層)

2) 非反応性の電荷輸送材料と、電荷輸送性骨格を有さず、反応性基を有する反応性基含有非電荷輸送材料と、を含む組成物の硬化膜で構成された層(つまり、非反応性の電荷輸送材料と、当該反応性基含有非電荷輸送材料の重合体又は架橋体と、を含む層)

40

【0254】

反応性基含有電荷輸送材料の反応性基としては、連鎖重合性基、エポキシ基、-OH、-OR[但し、Rはアルキル基を示す]、-NH₂、-SH、-COOH、-SiR^{Q1}_{3-Qn}(OR^{Q2})_{Qn}[但し、R^{Q1}は水素原子、アルキル基、又は置換若しくは無置換のアリール基を表し、R^{Q2}は水素原子、アルキル基、トリアルキルシリル基を表す。Qnは1~3の整数を表す]等の周知の反応性基が挙げられる。

【0255】

連鎖重合性基としては、ラジカル重合しうる官能基であれば特に限定されるものではな

50

く、例えば、少なくとも炭素二重結合を含有する基を有する官能基である。具体的には、ビニル基、ビニルエーテル基、ビニルチオエーテル基、スチリル基、ビニルフェニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、及びそれらの誘導体から選択される少なくとも一つを含有する基等が挙げられる。なかでも、その反応性に優れることから、連鎖重合性基としては、ビニル基、ビニルフェニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、及びそれらの誘導体から選択される少なくとも一つを含有する基であることが好ましい。

【0256】

反応性基含有電荷輸送材料の電荷輸送性骨格としては、電子写真感光体における公知の構造であれば特に限定されるものではなく、例えば、トリアリールアミン系化合物、ベンジジン系化合物、ヒドラゾン系化合物等の含窒素の正孔輸送性化合物に由来する骨格であって、窒素原子と共役している構造が挙げられる。これらの中でも、トリアリールアミン骨格が好ましい。

10

【0257】

これら反応性基及び電荷輸送性骨格を有する反応性基含有電荷輸送材料、非反応性の電荷輸送材料、反応性基含有非電荷輸送材料は、周知の材料から選択すればよい。

【0258】

保護層には、その他、周知の添加剤が含まれていてもよい。

【0259】

保護層の形成は、特に制限はなく、周知の形成方法が利用されるが、例えば、上記成分を溶剤に加えた保護層形成用塗布液の塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥し、必要に応じて加熱等の硬化処理することで行う。

20

【0260】

保護層形成用塗布液を調製するための溶剤としては、トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶剤；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶剤；エチレングリコールモノメチルエーテル等のセロソルブ系溶剤；イソプロピルアルコール、ブタノール等のアルコール系溶剤等が挙げられる。これら溶剤は、単独で又は2種以上混合して用いる。

なお、保護層形成用塗布液は、無溶剤の塗布液であってもよい。

【0261】

30

保護層形成用塗布液を感光層（例えば電荷輸送層）上に塗布する方法としては、浸漬塗布法、突き上げ塗布法、ワイヤーバー塗布法、スプレー塗布法、ブレード塗布法、ナイフ塗布法、カーテン塗布法等の通常の方法が挙げられる。

【0262】

保護層の膜厚は、例えば、好ましくは1 μm 以上20 μm 以下、より好ましくは2 μm 以上10 μm 以下の範囲内に設定される。

【0263】

（単層型感光層）

単層型感光層（電荷発生／電荷輸送層）は、例えば、電荷発生材料と電荷輸送材料と結着樹脂と、必要に応じて、その他周知の添加剤と、を含む層である。なお、これら材料は、電荷発生層及び電荷輸送層で説明した材料と同様である。

40

そして、単層型感光層中、電荷発生材料の含有量は、全固形分に対して10質量%以上85質量%以下がよく、好ましくは20質量%以上50質量%以下である。

一方、単層型感光層中、電荷輸送材料、結着樹脂（BPポリカーボネート樹脂）、酸化防止剤および紫外線吸収剤の含有量は電荷輸送層中での含有量と同様である。

単層型感光層の形成方法は、電荷発生層や電荷輸送層の形成方法と同様である。

単層型感光層の膜厚は、例えば、5 μm 以上50 μm 以下がよく、好ましくは10 μm 以上40 μm 以下である。

【0264】

<帯電装置>

50

帯電装置 8 としては、例えば、導電性又は半導電性の帯電ローラ、帯電ブラシ、帯電フィルム、帯電ゴムブレード、帯電チューブ等を用いた接触型帯電器が使用される。また、非接触方式のローラ帯電器、コロナ放電を利用したスコロトロン帯電器やコロトロン帯電器等のそれ自体公知の帯電器等も使用される。

【 0 2 6 5 】

< 露光装置 >

露光装置 9 としては、例えば、電子写真感光体 7 表面に、発光ダイオードの光を、定められた像様に露光する光学系機器等が適用される。つまり、露光装置 9 は、光源として発光ダイオード（LED：ライト・エミッティング・ダイオード）を有する露光装置が適用される。

10

具体的には、光源としてLEDを有する露光装置 9 としては、例えば、長尺状の基板上に多数のLEDが配列されたLEDアレイと、多数の屈折率分布型のロッドレンズが配列されたレンズアレイと、を備えたLEDプリントヘッドが挙げられる。なお、ここでアレイとは、複数のLEDや複数のレンズ等の素子が、一次元状又は二次元状に配列された素子列を意味している。LEDアレイには、例えば、1インチ当り1200画素（即ち、1200 dpi（dot per inch））と、主走査方向の画素数に対応して多数のLEDが配列されている。屈折率分布型のロッドレンズとしては、円柱状のロッドレンズが用いられる。

。なお、LEDは、照射する光の波長が電子写真感光体 7 の分光感度領域内にあるものが適用されることがよい。

20

【 0 2 6 6 】

< 現像装置 >

現像装置 11 としては、例えば、現像剤を接触又は非接触させて現像する一般的な現像装置が挙げられる。現像装置 11 としては、上述の機能を有している限り特に制限はなく、目的に応じて選択される。例えば、一成分系現像剤又は二成分系現像剤をブラシ、ローラ等を用いて電子写真感光体 7 に付着させる機能を有する公知の現像器等が挙げられる。中でも現像剤を表面に保持した現像ローラを用いるものが好ましい。

【 0 2 6 7 】

現像装置 11 に使用される現像剤は、トナー単独の一成分系現像剤であってもよいし、トナーとキャリアとを含む二成分系現像剤であってもよい。また、現像剤は、磁性であってもよいし、非磁性であってもよい。これら現像剤は、周知のものが適用される。

30

【 0 2 6 8 】

< クリーニング装置 >

クリーニング装置 13 は、クリーニングブレード 131 を備えるクリーニングブレード方式の装置が用いられる。

なお、クリーニングブレード方式以外にも、ファークラシクリーニング方式、現像同時クリーニング方式を採用してもよい。

【 0 2 6 9 】

< 転写装置 >

転写装置 40 としては、例えば、ベルト、ローラ、フィルム、ゴムブレード等を用いた接触型転写帯電器、コロナ放電を利用したスコロトロン転写帯電器やコロトロン転写帯電器等のそれ自体公知の転写帯電器が挙げられる。

40

【 0 2 7 0 】

< 中間転写体 >

中間転写体 50 としては、半導電性を付与したポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ゴム等を含むベルト状のもの（中間転写ベルト）が使用される。また、中間転写体の形態としては、ベルト状以外にドラム状のものをを用いてもよい。

【 0 2 7 1 】

図 3 は、本実施形態に係る画像形成装置の他の一例を示す概略構成図である。

50

図3に示す画像形成装置120は、プロセスカートリッジ300を4つ搭載したタンデム方式の多色画像形成装置である。画像形成装置120では、中間転写体50上に4つのプロセスカートリッジ300がそれぞれ並列に配置されており、1色につき1つの電子写真感光体が使用される構成となっている。なお、画像形成装置120は、タンデム方式であること以外は、画像形成装置100と同様の構成を有している。

【実施例】

【0272】

以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0273】

<感光体の作製>

〔感光体1〕

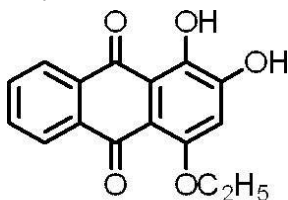
酸化亜鉛（商品名：MZ 300、テイカ株式会社製）100質量部、シランカップリング剤としてN-2-（アミノエチル）-3-アミノプロピルトリエトキシシランの10質量%のトルエン溶液を10質量部、トルエン200質量部を混合して攪拌を行い、2時間還流を行った。その後10mmHgにてトルエンを減圧留去し、135℃で2時間焼き付けて、シランカップリング剤による酸化亜鉛の表面処理を行った。

表面処理した酸化亜鉛：33質量部、ブロック化イソシアネート（商品名：スミジュール3175、住友バイエルンウレタン社製）：6質量部、下記構造式（AK-1）で示される化合物：1質量部、メチルエチルケトン：25質量部を30分間混合し、その後ブチラール樹脂（商品名：エスレックBM-1、積水化学工業社製）：5質量部、シリコーンボール（商品名：トスパール120、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製）：3質量部、レベリング剤としてシリコーンオイル（商品名：SH29PA、東レダウコーニングシリコーン社製）：0.01質量部を添加し、サンドミルにて3時間の分散を行い、下引層形成用塗布液を得た。

さらに、浸漬塗布法にて、下引層形成用塗布液を、直径30mm、長さ340mm、肉厚0.7mmのアルミニウム基材上に塗布し、185℃、30分の乾燥硬化を行い、膜厚30μmの下引層を得た。

【0274】

【化24】



(AK-1)

【0275】

次に、電荷発生材料としてのヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料「Cuk 特性X線を用いたX線回折スペクトルのブラッグ角度（ $2\theta \pm 0.2^\circ$ ）が少なくとも 7.3° 、 16.0° 、 24.9° 、 28.0° の位置に回折ピークを有するV型のヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料（600nm以上900nm以下の波長域での分光吸収スペクトルにおける最大ピーク波長=820nm、平均粒径=0.12μm、最大粒径=0.2μm、比表面積値=60m²/g）」、結着樹脂としての塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂（商品名：VMCH、日本ユニカー社製）、およびn-酢酸ブチルからなる混合物を、容量100mLガラス瓶中に、充填率50%で1.0mmガラスビーズと共に入れて、ペイントシェーカーを用いて2.5時間分散処理し、電荷発生層用塗布液を得た。ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料と塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂の混合物に対して、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料の含有率を55.0体積%とし、分散液の固形分は6.0質量%とした。含有率は、ヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料の比

重を 1.606 g/cm^3 、塩化ビニル - 酢酸ビニル共重合体樹脂の比重 1.35 g/cm^3 をとして計算した。

得られた電荷発生層形成用塗布液を、下引層上に浸漬塗布し、100 で5分間乾燥して、膜厚 $0.20 \mu\text{m}$ の電荷発生層を形成した。

【0276】

次に、電荷輸送材料として、ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) 「例示化合物 (CT1-1)」8.0質量部およびベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) 「例示化合物 (CT2-1)」32.0質量部と、結着樹脂として、BPポリカーボネート樹脂「例示化合物 (PC-1)、 $p_m : p_n = 25 : 75$ 、粘度平均分子量 = 5万」60.0質量部と、フッ素含有樹脂粒子として、4フッ化エチレン樹脂粒子 (体積平均粒子径 200 nm) : 8質量部と、フッ素含有分散剤として、GF400 (東亜合成社製：フッ化アルキル基を持つメタクリレートを少なくとも重合成分とした界面活性剤) : 0.3質量部と、酸化防止剤として、ヒンダードフェノール系酸化防止剤「例示化合物 (HP-1)、分子量775」3.2質量部 (全電荷輸送材料合計量100質量%に対して8.0質量%) とを、テトラヒドロフラン340.0質量部に加えて溶解し、電荷輸送層形成用塗布液を得た。

10

得られた電荷輸送層形成用塗布液を、電荷発生層上に浸漬塗布し、140、25分の乾燥を行うことにより、膜厚 $25 \mu\text{m}$ の電荷輸送層を形成した。

【0277】

以上の工程を経て、感光体1を得た。

【0278】

20

[感光体2~4]

表1に従って、電荷輸送材料の種類と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の種類とを変更した以外は、感光体1と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0279】

[感光体5]

酸化防止剤としてのヒンダードフェノール系酸化防止剤に代えて、紫外線吸収剤として、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤「例示化合物 (BP-1)」3.2質量部 (全電荷輸送材料合計量100質量%に対して8.0質量%) を使用した以外は、感光体1と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0280】

30

[感光体6~8]

表1に従って、電荷輸送材料の種類と、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体5と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0281】

[感光体9]

酸化防止剤として、ヒンダードフェノール系酸化防止剤「例示化合物 (HP-1)、分子量775」3.2質量部 (全電荷輸送材料合計量100質量%に対して8.0質量%) と共に、更に、紫外線吸収剤として、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤「例示化合物 (BP-1)」3.2質量部 (全電荷輸送材料合計量100質量%に対して8.0質量%) を使用した以外は、感光体1と同様にして、電子写真感光体を作製した。

40

【0282】

[感光体10]

表1に従って、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の種類と、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体9と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0283】

[感光体11~20]

表1に従って、電荷輸送材料の種類と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤の種類と、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の種類とを変更した以外は、感光体9と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【0284】

50

[感光体 2 1 ~ 2 5]

表 1 に従って、酸化防止剤としてのヒンダードフェノール系酸化防止剤の量と、紫外線吸収剤としてのベンゾフェノン系紫外線吸収剤の量とを変更した以外は、感光体 2 0 と同様に、電子写真感光体を作製した。

【 0 2 8 5 】

[感光体 2 6 ~ 3 7]

表 2 に従って、電荷輸送材料の種類及び量と、酸化防止剤の種類及び量と、紫外線吸収剤の種類及び量とを変更した以外は、感光体 9 と同様に、電子写真感光体を作製した。

【 0 2 8 6 】

10

[感光体 3 8]

B P ポリカーボネート樹脂に代えて、ビスフェノール Z 型ポリカーボネート樹脂 P C Z 4 0 0 (ビスフェノール Z の単独重合型ポリカーボネート樹脂、粘度平均分子量 3 . 9 万) 」 6 0 . 0 質量部を使用した以外は、感光体 3 2 と同様にして、電子写真感光体を作製した。

【 0 2 8 7 】

< 実施例 1 >

得られた電子写真感光体 (感光体 1) を電子写真方式の画像形成装置 (富士ゼロックス社製 : D o c u C e n t r e S C 2 0 2 1 改造機) に搭載し、この改造機を実施例 1 の画像形成装置とした。なお、改造機に搭載した静電潜像形成装置は、発光ダイオードを光源とした静電潜像形成装置である。

20

【 0 2 8 8 】

< 実施例 2 ~ 3 1 および比較例 1 ~ 7 >

感光体の種類を表 3、4 に従って変更した以外は実施例 1 と同様の画像形成装置 (実施例 2 ~ 2 5 および比較例 1 ~ 7) とした。

【 0 2 8 9 】

< 評価 >

各例の画像形成装置を用い、下記要領で、「焼付きゴースト」、「光疲労」、「ハーフトーン画像濃度」の評価を行った。

【 0 2 9 0 】

30

(焼付きゴーストの評価)

各例の画像形成装置を用い、A 3 サイズの用紙に格子模様チャートを 3 0 0 0 枚連続出力した後、A 3 サイズの用紙に、画像濃度 2 0 % の全面ハーフトーン画像 (C y a n 色の全面ハーフトーン画像) を 1 枚出力した。

そして、出力した全面ハーフトーン画像を観察し、格子模様の連続画像出力部と非連続画像出力部との濃度差について、目視による官能評価 (グレード判定) を実施した。グレード判定は 0 G ~ 5 G まで 0 . 5 G 刻みで行い、G の数字が小さい程、濃度差が小さく、焼付きゴーストが発生していないことを示す。焼付きゴーストの許容グレードは 3 . 5 G 以下である。なお、画像出力は全て 2 8 、 8 5 % R H の環境下で実施した。結果を表 3 ~ 表 5 に示す。

40

【 0 2 9 1 】

(光疲労の評価)

先ず、電子写真感光体 (感光体 1 ~ 3 8) を各例の画像形成装置に搭載する前に、2 c m 四方の窓を開けた黒紙に巻き、窓開け部のみが光暴露されるようにして、白色蛍光灯 (1 0 0 0 L u x) 下で 1 0 分間放置し、電子写真感光体を光暴露させた。

次に、光暴露させた電子写真感光体を、各例の画像形成装置に搭載し、A 3 サイズの用紙に、画像濃度 5 0 % の全面ハーフトーン画像 (C y a n) を 1 枚出力した。

そして、出力した全面ハーフトーン画像を観察し、光暴露部と非光暴露部との濃度差について、目視による官能評価 (グレード判定) を実施した。グレード判定は 0 G ~ 5 G まで 0 . 5 G 刻みで行い、G の数字が小さい程、濃度差が小さく、光疲労が発生していない

50

ことを示す。光疲労の許容グレードは 3 . 5 G 以下である。なお、画像出力は全て 2 8 、 8 5 % R H の環境下で実施した。結果を表 3 ~ 表 4 に示す。

【 0 2 9 2 】

(ハーフトーン画像濃度の評価)

各例の画像形成装置を用い、 A 3 サイズの用紙に、画像濃度 5 0 % の全面ハーフトーン画像 (C y a n) を 1 枚出力した。

そして、出力した全面ハーフトーン画像を観察し、目的とする画像濃度が出力されているかを調べた。なお、画像出力は全て 2 8 、 8 5 % R H の環境下で実施した。結果を表 3 ~ 表 4 に示す。

【 0 2 9 3 】

【表 1】

	電荷輸送材料				結着樹脂		酸化防止剤				紫外線吸収剤			
	(CT1)		(CT2)		例示化合物 No	pm/pn	例示化合物 No	分子量	量部数	質量%	例示化合物 No	量部数	質量%	
	例示化合物 No	量部数	例示化合物 No	量部数										
感光体 1	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 2	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-2	784	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 3	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 4	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-2	784	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 5	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 6	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-2	3.2	8.0	
感光体 7	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 8	CT1-2	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-2	3.2	8.0	
感光体 9	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 10	CT1-1	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-2	784	3.2	8.0	BP-2	3.2	8.0	
感光体 11	CT1-3	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 12	CT1-3	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 13	CT1-3	8.0	CT2-1	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 14	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 15	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 16	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-1	775	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 17	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 18	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-1	3.2	8.0	
感光体 19	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	無し	0	0	
感光体 20	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0	
感光体 21	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	4.8	12.0	BP-3	4.8	12.0	
感光体 22	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	5.8	14.5	BP-3	5.8	14.5	
感光体 23	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	6.4	16.0	BP-3	6.4	16.0	
感光体 24	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	11.6	29.0	BP-3	11.6	28.9	
感光体 25	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HP-3	340	12.5	30.3	BP-3	12.5	30.1	

【 表 2 】

	電荷輸送材料				結着樹脂		酸化防止剤				紫外線吸収剤		
	(CT1)		(CT2)		例示 化合物 No	pm/pn	例示 化合物 No	分子 量	量 部数	量 質量%	例示 化合物 No	量 部数	量 質量%
	例示 化合物 No	量 部数	例示 化合物 No	量 部数									
感光体 26	CT1-3	16.0	CT2-2	24.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 27	CT1-3	20.0	CT2-2	20.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 28	CT1-3	24.0	CT2-2	16.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 29	CT1-3	4.0	CT2-2	36.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 30	CT1-3	24.0	CT2-2	19.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 31	CT1-3	36.0	CT2-2	4.0	PC-1	25/75	HP-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 32	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	無し	0	0
感光体 33	無し	0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	HF-3	340	3.2	8.0	BP-3	3.2	8.0
感光体 34	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	CAO-1	220	3.2	8.0	無し	0	0
感光体 35	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	無し	—	0	0	CUA-1	3.2	8.0
感光体 36	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	CAO-1	220	3.2	8.0	CUA-1	3.2	8.0
感光体 37	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PC-1	25/75	CAO-2	—	3.2	8.0	無し	0	0
感光体 38	CT1-3	8.0	CT2-2	32.0	PCZ500	—	無し	—	0	0	無し	0	0

【 0 2 9 5 】

10

20

30

40

50

【表 3】

	感光体 No.	静電潜像形成装置の設定		評価		
		光源	露光から現像までの時間(秒)	焼付き ゴースト	光疲労	ハーフトン 画像濃度
実施例 1	感光体 1	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 2	感光体 2	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 3	感光体 3	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 4	感光体 4	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 5	感光体 5	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 6	感光体 6	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 7	感光体 7	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 8	感光体 8	発光ダイオード	0.151	3.0G	3.5G	良好
実施例 9	感光体 9	発光ダイオード	0.151	2.5G	2.5G	良好
実施例 10	感光体 10	発光ダイオード	0.151	2.5G	3.0G	良好
実施例 11	感光体 11	発光ダイオード	0.151	2.5G	2.5G	良好
実施例 12	感光体 12	発光ダイオード	0.151	2.0G	3.0G	良好
実施例 13	感光体 13	発光ダイオード	0.151	2.0G	2.5G	良好
実施例 14	感光体 14	発光ダイオード	0.151	1.5G	2.0G	良好
実施例 15	感光体 15	発光ダイオード	0.151	1.5G	1.5G	良好
実施例 16	感光体 16	発光ダイオード	0.151	1.5G	1.0G	良好
実施例 17	感光体 17	発光ダイオード	0.151	1.5G	1.0G	良好
実施例 18	感光体 18	発光ダイオード	0.151	1.0G	0.5G	良好
実施例 19	感光体 19	発光ダイオード	0.151	0.5G	0G	良好
実施例 20	感光体 20	発光ダイオード	0.151	0G	0G	良好
実施例 21	感光体 21	発光ダイオード	0.151	0G	0G	僅かに薄い
実施例 22	感光体 22	発光ダイオード	0.151	0G	0G	僅かに薄い
実施例 23	感光体 23	発光ダイオード	0.151	0G	0G	やや薄い
実施例 24	感光体 24	発光ダイオード	0.151	0G	0G	やや薄い
実施例 25	感光体 25	発光ダイオード	0.151	0G	0G	薄い

【 0 2 9 6 】

【表 4】

	感光体 No.	静電潜像形成装置の設定		評価		
		光源	露光から現像までの時間(秒)	焼付き ゴースト	光疲労	ハーフトン 画像濃度
実施例 26	感光体 26	発光ダイオード	0.151	0G	0G	良好
実施例 27	感光体 27	発光ダイオード	0.151	1.0G	0.5G	良好
実施例 28	感光体 28	発光ダイオード	0.151	1.0G	0.5G	良好
実施例 29	感光体 29	発光ダイオード	0.151	0G	0G	やや薄い
実施例 30	感光体 30	発光ダイオード	0.151	2.0G	1.5G	良好
実施例 31	感光体 31	発光ダイオード	0.151	3.0G	2.5G	良好
比較例 1	感光体 32	発光ダイオード	0.151	5.0G	5.0G	良好
比較例 2	感光体 33	発光ダイオード	0.151	判定不可	判定不可	濃度不良
比較例 3	感光体 34	発光ダイオード	0.151	5.0G	5.0G	良好
比較例 4	感光体 35	発光ダイオード	0.151	5.0G	5.0G	良好
比較例 5	感光体 36	発光ダイオード	0.151	5.0G	4.5G	良好
比較例 6	感光体 37	発光ダイオード	0.151	5.0G	5.0G	良好
比較例 7	感光体 38	発光ダイオード	0.151	3.5G	5.0G	良好

【 0 2 9 7 】

上記結果から、本実施例では、比較例に比べ、「焼付きゴースト」および「光疲労」が抑制されていることがわかる。

また、ヒンダードフェノール系酸化防止剤およびベンゾフェノン系紫外線吸収剤の配合量が適切な実施例 1 ~ 20 は、実施例 21 ~ 25 に比べ、目的とするハーフトーン画像濃度が得られていることがわかる。

【0298】

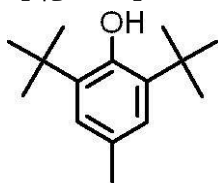
ここで、感光体に静電潜像を書き込む露光装置として、レーザ光源から射出された光をポリゴンミラーで走査するレーザROS (Raster Output Scanner) 方式の露光装置を備える画像形成装置 (露光から現像までの時間 0.07 秒) に、感光体 1 (実施例対応の感光体) を搭載し、「焼付きゴースト」および「光疲労」を評価したところ、「焼付きゴースト」は 1.5 G、「光疲労」2.0 G であった。このことから、光源として発光ダイオードを有する露光装置を備える画像形成装置では、「焼付きゴースト」および「光疲労」が生じ易く、本実施例ではこれらが改善されていることがわかる。

【0299】

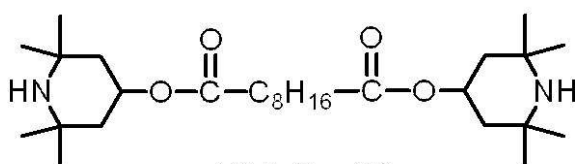
なお、表 1 ~ 表 2 の略称等の詳細は以下の通りである。

- ・CT1-1: ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) の例示化合物 (CT1-1)
- ・CT1-2: ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) の例示化合物 (CT1-2)
- ・CT1-3: ブタジエン系電荷輸送材料 (CT1) の例示化合物 (CT1-3)
- ・CT2-1: ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) の例示化合物 (CT2-1)
- ・CT2-2: ベンジジン系電荷輸送材料 (CT2) の例示化合物 (CT2-2)
- ・PC-1: BP ポリカーボネート樹脂の例示化合物 (PC-1)
- ・PCZ400: ビスフェノール Z 型ポリカーボネート樹脂 (ビスフェノール Z の単独重合型ポリカーボネート樹脂、粘度平均分子量 3.9 万)
- ・HP-1: ヒンダードフェノール系酸化防止剤の例示化合物 (HP-1)
- ・HP-2: ヒンダードフェノール系酸化防止剤の例示化合物 (HP-2)
- ・HP-3: ヒンダードフェノール系酸化防止剤の例示化合物 (HP-3)
- ・CAO-1: 酸化防止剤の比較化合物 (下記構造式 (CAO-1) で示されるヒンダードフェノール系酸化防止剤参照)
- ・CAO-2: 酸化防止剤の比較化合物 (下記構造式 (CAO-2) で示されるヒンダードアミン系酸化防止剤参照)

【化25】



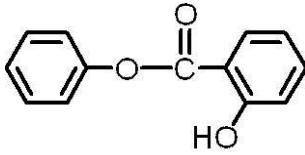
(CAO-1)



(CAO-2)

- ・BP-1: ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例示化合物 (BP-1)
- ・BP-2: ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例示化合物 (BP-2)
- ・BP-3: ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例示化合物 (BP-3)
- ・CUA-1: 紫外線吸収剤の比較化合物 (下記構造式 (CUA-1) で示されるベンゾエート系紫外線吸収剤参照)

【化 2 6】



(CUA-1)

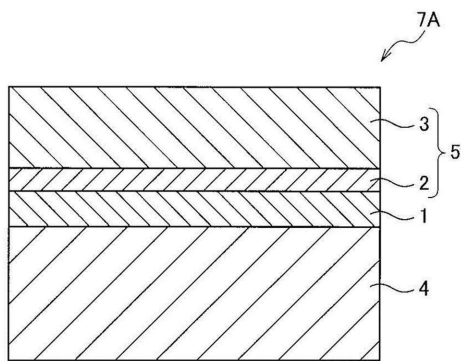
【符号の説明】

【0300】

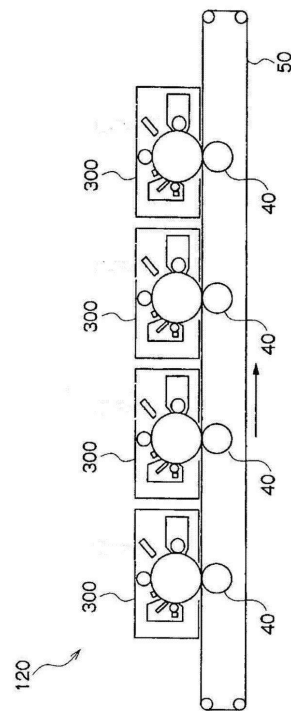
1 下引層、2 電荷発生層、3 電荷輸送層、4 導電性基体、7A, 7 電子写真感光体、8 帯電装置、9 露光装置、11 現像装置、13 クリーニング装置、14 潤滑剤、40 転写装置、50 中間転写体、100 画像形成装置、120 画像形成装置、131 クリーニングブレード、132 繊維状部材（ロール状）、133 繊維状部材（平ブラシ状）、300 プロセカートリッジ

10

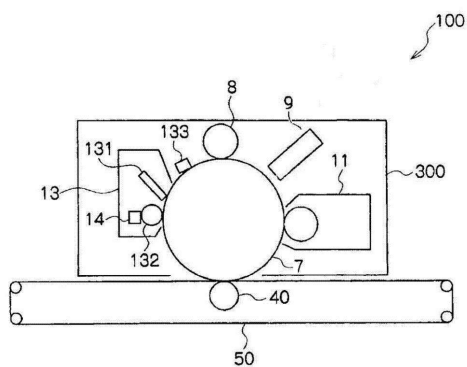
【図 1】



【図 3】



【図 2】



フロントページの続き

- (72)発明者 川崎 晃弘
神奈川県海老名市本郷2 2 7 4 番地 富士ゼロックス株式会社内
- (72)発明者 橋場 成人
神奈川県海老名市本郷2 2 7 4 番地 富士ゼロックス株式会社内

審査官 外川 敬之

- (56)参考文献 特開2 0 1 2 - 0 4 7 9 5 9 (J P , A)
特開昭5 8 - 1 6 3 9 4 5 (J P , A)
特開平1 0 - 1 7 7 2 6 1 (J P , A)
米国特許出願公開第2 0 1 5 / 0 0 7 9 5 1 1 (U S , A 1)

- (58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
- | | |
|---------|---------|
| G 0 3 G | 5 / 0 0 |
| G 0 3 G | 5 / 0 6 |